

最大 80 個の LED を駆動可能 FET 内蔵 8ch 白色 LED ドライバ



BD6142AMUV

●概要

この IC は最大 41V まで昇圧可能な PWM 方式 DC/DC コンバータと最大 30mA までドライブ可能なカレントドライバを集積した白色 LED ドライバです。外部からの PWM 信号によって制御することで広範囲かつ高精度な輝度制御を行うことが可能です。各端子間のマッチング精度が良いカレントドライバを採用しており、ディスプレイの輝度ムラを低減する為に最適です。基板の小型化、省スペース化にメリットある小型パッケージです。

●重要特性

■ 動作電源電圧範囲	4.2V~27.0V
■ LED 最大電流	30mA (Max.)
■ 静止電流	1.6μA (Typ.)
■ スwitching 周波数	1.25MHz (Typ.)
■ 動作温度範囲	-40°C~+85°C

●パッケージ

VQFN024V4040 W(Typ.) x D(Typ.) x H(Max.)
4.00mm x 4.00mm x 1.00mm

●特長

- 高精度&高マッチングカレントドライバ 8ch (最大 30mA/ch)
- 50V Nch MOSFET 内蔵
- ソフトスタート
- 白色 LED が最大 11 直列 x 8 並列
- 豊富な保護回路
 - ・ 過電圧保護
 - ・ 外付け SBD 外れ保護/ 出力ショート保護
 - ・ 過電流保護
 - ・ LED オープン保護 / GND ショート保護
 - ・ LED ショート保護 / CH 端子過電圧保護
 - ・ サーマルシャットダウン
 - ・ UVLO
- アナログ調光対応



VQFN024V4040
4.00mm x 4.00mm x 1.00mm

Figure 1. パッケージ

●用途

モバイルノート PC、Net PC、モニター、小型 TV、光源、ポータブル DVD プレイヤーなどの中型 LCD 機器 全般バックライト

●基本アプリケーション回路(8 並列)

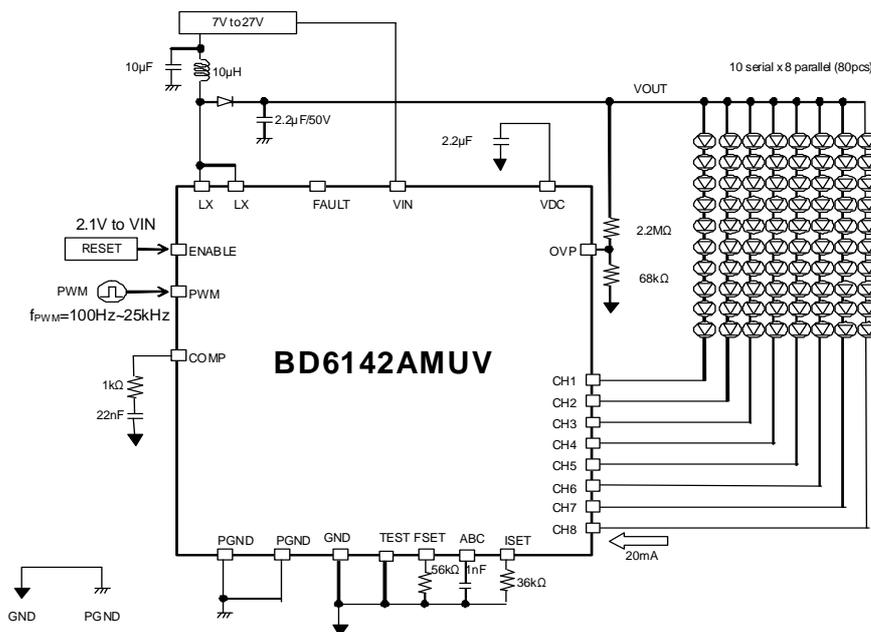


Fig.2 基本アプリケーション回路

○製品構造：シリコンモノリシック集積回路 ○耐放射線設計はしていません

●絶対最大定格(Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Ratings	Unit	Condition
端子電圧 1	VMAX1	7	V	VDC, ISET, ABC, COMP, FSET, TEST, FAULT
端子電圧 2	VMAX2	45	V	CH1~CH8, LX, OVP
端子電圧 3	VMAX3	30.5	V	VIN, ENABLE
端子電圧 4	VMAX4	15	V	PWM
許容損失 1	Pd1	500 ^{*1}	mW	-
許容損失 2	Pd2	780 ^{*2}	mW	-
許容損失 3	Pd3	1510 ^{*3}	mW	-
動作温度範囲	Topr	-40~+85	°C	-
保存温度範囲	Tstg	-55~+150	°C	-

*1 Ta=25°C以上で使用する時は約 4.0mW/°Cで減ずる。(IC 単体時)。

*2 1層(ローコスト標準基板)実装時。銅箔面積 0mm², Ta=25°C以上で使用する時は約 6.2mW/°Cで減ずる。

*3 4層(JEDEC 準拠基板)実装時。銅箔面積 1層目 6.28mm²、銅箔面積 2~4層目 5655.04mm²。

Ta=25°C以上で使用する時は約 12.1mW/°Cで減ずる。

●推奨動作範囲(Ta=-40°C~+85°C)

Parameter	Symbol	Limits			Unit	Conditions
		Min.	Typ.	Max.		
動作電源電圧	VIN	4.2	12.0	27.0	V	

●電気的特性

(特に指定のない限り、VIN=12V, Ta = +25°C)

Parameter	Symbol	Limits			Unit	Conditions
		Min.	Typ.	Max.		
[全般]						
静止電流	Iq	-	1.6	4.4	μA	ENABLE=0V
動作電流	Idd	-	3.6	5.4	mA	OVP=0V, ISET=36kΩ
最大出力電圧	MOV	-	-	41	V	-
低電圧検出電圧	UVLO	3.1	3.7	4.1	V	VIN 下降時
[ENABLE 端子]						
L レベル入力電圧	EnL	0.0	-	0.8	V	-
H レベル入力電圧 1	EnH	2.0	-	VIN	V	-
ENABLE プルダウン抵抗	EnR	100	300	500	kΩ	ENABLE =3V
出力電流	ENIout	-	0	2	μA	ENABLE =0V
[PWM 端子]						
L レベル入力電圧	PWML	0.0	-	0.8	V	-
H レベル入力電圧 2	PWMH	1.3	-	12.0	V	-
PWM プルダウン抵抗	PWMR	100	300	500	kΩ	PWM=3V
出力電流	PWMIout	-	0	2	μA	PWM=0V
[FAULT]						
Nch RON	FFCR	-	-	3	kΩ	ENABLE =PWM=3V, OVP=2V
[レギュレータ]						
VDC 電圧	VREG	4.2	5.0	6.0	V	無負荷, VIN > 6V

● 電気的特性 - 続き

(特に指定のない限り、VIN=12V, Ta = +25°C)

Parameter	Symbol	Limits			Unit	Conditions
		Min.	Typ.	Max.		
[スイッチングレギュレータ]						
LED 制御電圧	VLED	0.64	0.80	0.96	V	-
スイッチング周波数	Fsw	1.00	1.25	1.50	MHz	FSET=56kΩ
最大 duty	Duty	91.0	95.0	99.0	%	CH1-8=0.3V, FSET=56kΩ
LX Nch FET RON	RON	-	0.48	0.58	Ω	ILX=80mA
[プロテクション]						
過電流リミット	Ocp	1.5	2.5	-	A	*1
過電圧リミット	OVP	1.16	1.20	1.24	V	OVP 端子の検出電圧
出力ショート保護	OVPfault	0.02	0.05	0.08	V	OVP 端子の検出電圧
OVP リーク電流	OVIL	-	0.1	1.0	μA	-
CH 端子 過電圧保護ばらつき	VSC	-15	0	+15	%	VSC=5V
[カレントドライバ]						
LED 最大電流	ILMAX	-	-	30	mA	-
LED 電流ばらつき	ILACCU	-	-	±2.5	%	ILED=20mA (36kΩ)
LED 電流マッチング	ILMAT	-	-	2.5	%	(最大LED 電流 - 最小LED 電流) / 理想的電流(20mA) ILED=20mA
LED 電流マッチング 2	ILMAT2	-	-	1.5	%	・各 LED 電流/平均 (CH1- 8) ・ILED=20mA
LED 端子保護	ILOCP	-	0	0.1	mA	ISET 抵抗 1kΩ 設定時の 電流リミット値
ISET 電圧	Iset	-	0.733	-	V	-
LED 電流ばらつき 2	ILACCU2	-	±3.0	-	%	ILED=20mA, ABC=0.733V

*1 この項目は、DC で測定しています。

●端子説明

Pin No.	Pin Name	IO	Function	Terminal diagram
1	ENABLE	In	オン/オフ制御用の端子	E
2	TEST	In	TEST 信号(IC 内部のプルダウン 100 kΩ)	E
3	FSET	In	周波数設定用抵抗を接続 (P17 参照ください)	A
4	ABC	In	アナログ輝度制御 PIN	C
5	GND	-	スイッチングレギュレータ GND	B
6	PWM	In	カレントドライバのオン/オフ用 PWM 入力端子	E
7	CH8	In	CH8 用カレントドライバの sink 端子	C
8	CH7	In	CH7 用カレントドライバの sink 端子	C
9	CH6	In	CH6 用カレントドライバの sink 端子	C
10	CH5	In	CH5 用カレントドライバの sink 端子	C
11	ISET	In	LED 電流設定端子 (P17 参照ください)	A
12	CH4	In	CH4 用カレントドライバの sink 端子	C
13	CH3	In	CH3 用カレントドライバの sink 端子	C
14	CH2	In	CH2 用カレントドライバの sink 端子	C
15	CH1	In	CH1 用カレントドライバの sink 端子	C
16	OVP	In	SBD Open と過電圧保護の検出端子です。 過電圧設定用の抵抗が接続されます (P10-12 を参照ください)	C
17	PGND	-	スイッチング Tr の PGND 端子	D
18				
19	LX	Out	スイッチング Tr のドレイン端子でコイルが接続 されます(P19 をご参照ください)	F
20		Out		F
21	FAULT	Out	Fault 信号	C
22	COMP	Out	ERRAMP 信号	A
23	VIN	In	バッテリー入力	G
24	VDC	Out	レギュレータ出力/内部電源	C
-	Thermal PAD	-	裏面の放熱 PAD GND に接続してください。	-

●ESD 等価回路図

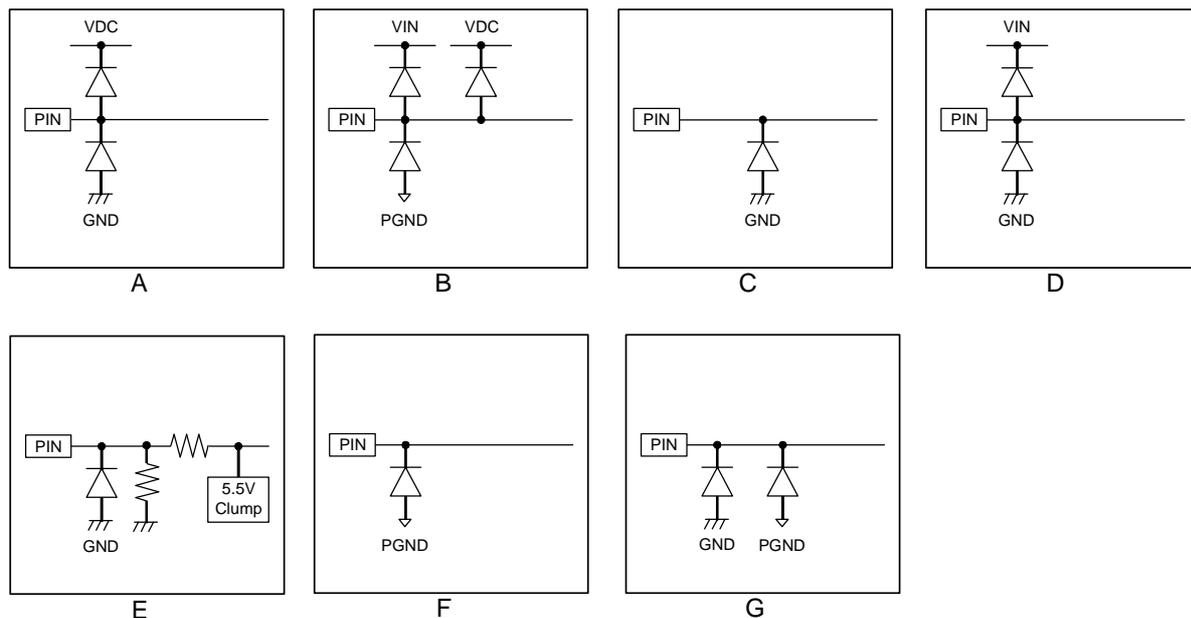
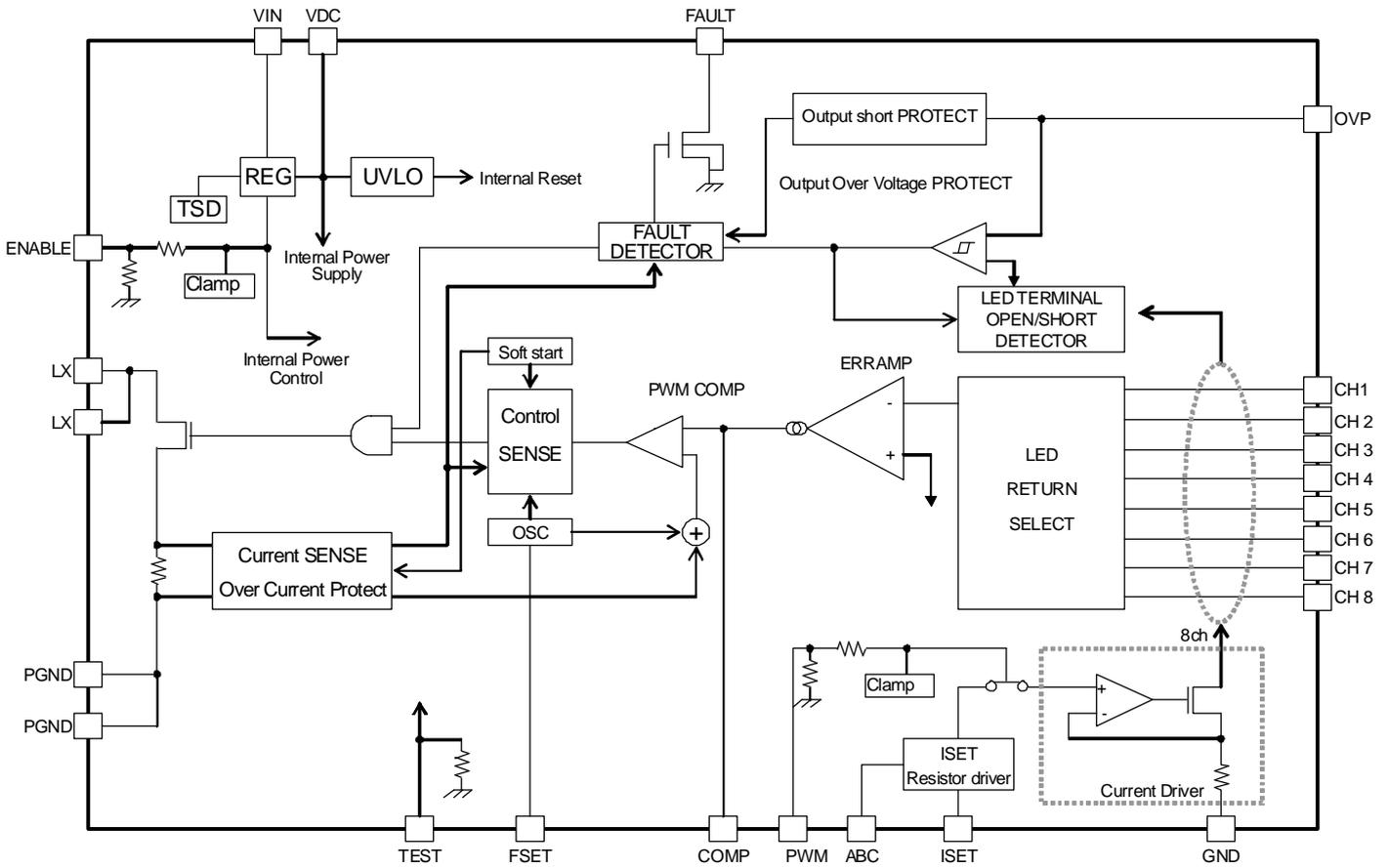


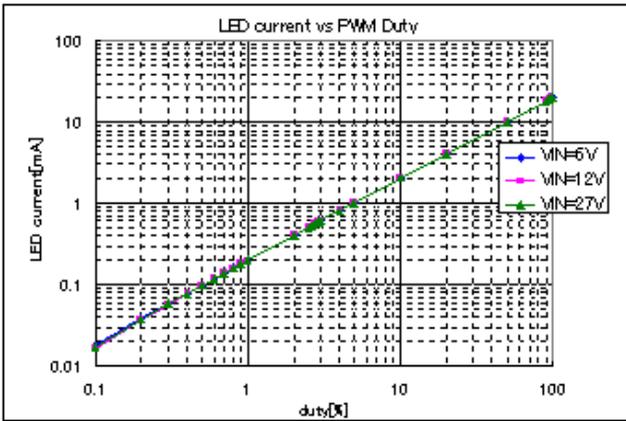
Figure 3. Pin ESD Type

●ブロック図



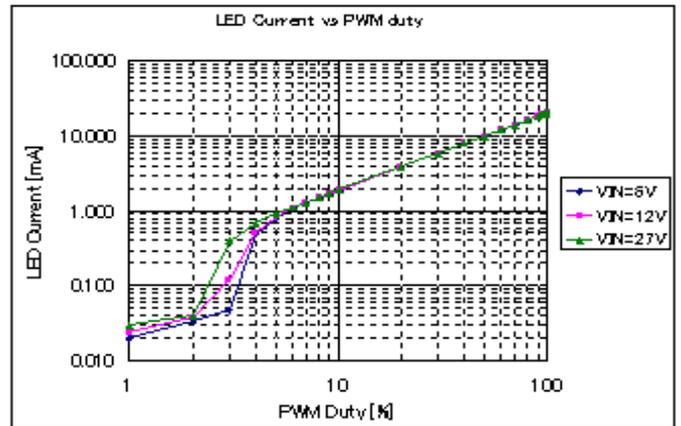
Pin number 24pin
Figure 4. Block diagram

●参考データ



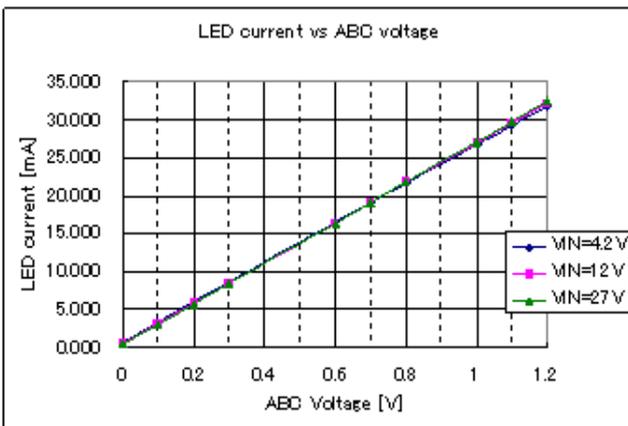
- <条件>
- 10直列×8並列
 - Ta = 25°C
 - LED電流 = 20mA
 - PWM周波数 = 200Hz
 - 周波数 = 1.25MHz(FSET = 56kΩ)
 - コイル = 10μH

Figure 5. LED 電流特性 PWM 調光時



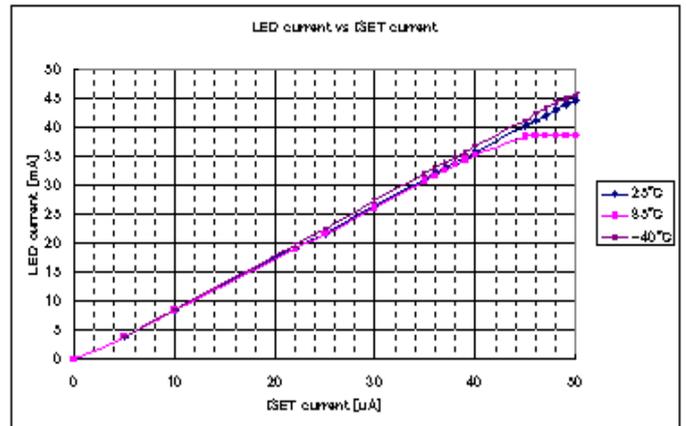
- <条件>
- 10直列×8並列
 - Ta = 25°C
 - LED 電流 = 20mA
 - PWM周波数 = 30kHz
 - 周波数 = 1.25MHz(FSET=56kΩ)
 - コイル = 4.7μH

Figure 6. LED 電流特性 PWM 調光時



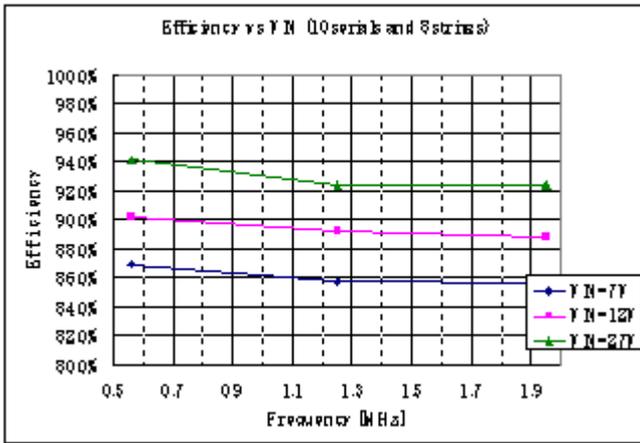
- <条件>
- Ta = 25°C
 - ISET = 36kΩ
 - CH1 = 0.8V

Figure 7. LED 電流特性 アナログ調光時



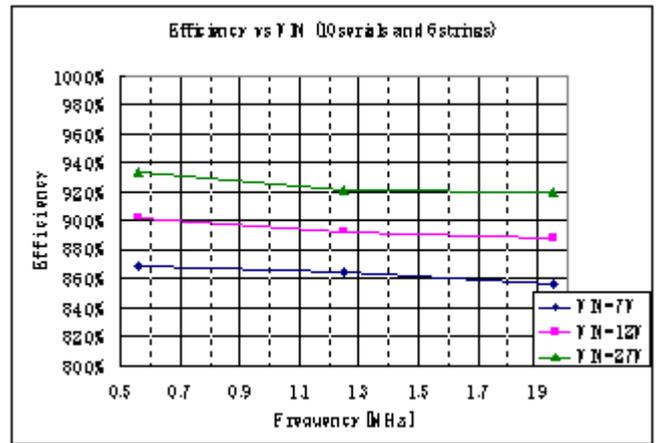
- <条件>
- VIN = 12V
 - CH1 = 0.8V

Figure 8. LED 最大電流



<条件>
 ■Ta = 25°C
 ■10直列×8並列
 ■LED 電流 = 20mA
 ■コイル= TDK, LTF5022T-100M1R4-LC

Figure 9. 効率



<条件>
 ■Ta = 25°C
 ■10直列×6並列
 ■LED 電流 = 20mA
 ■コイル= TDK, LTF5022T-100M1R4-LC

Figure 10. 効率

●アプリケーション例

Figure 11. Figure 12. Figure 13.は 15.4inch、12inch、10.1inch モデルのアプリケーション例になります。22 ページのレイアウト図もご参考ください。

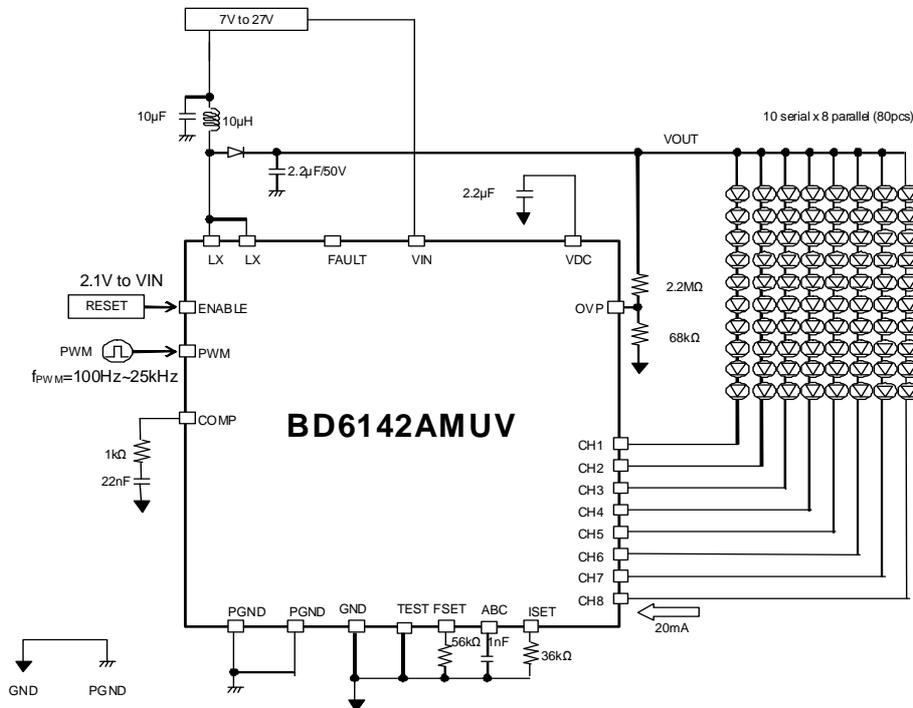


Figure 11. BD6142AMUV Application example (8 parallel)

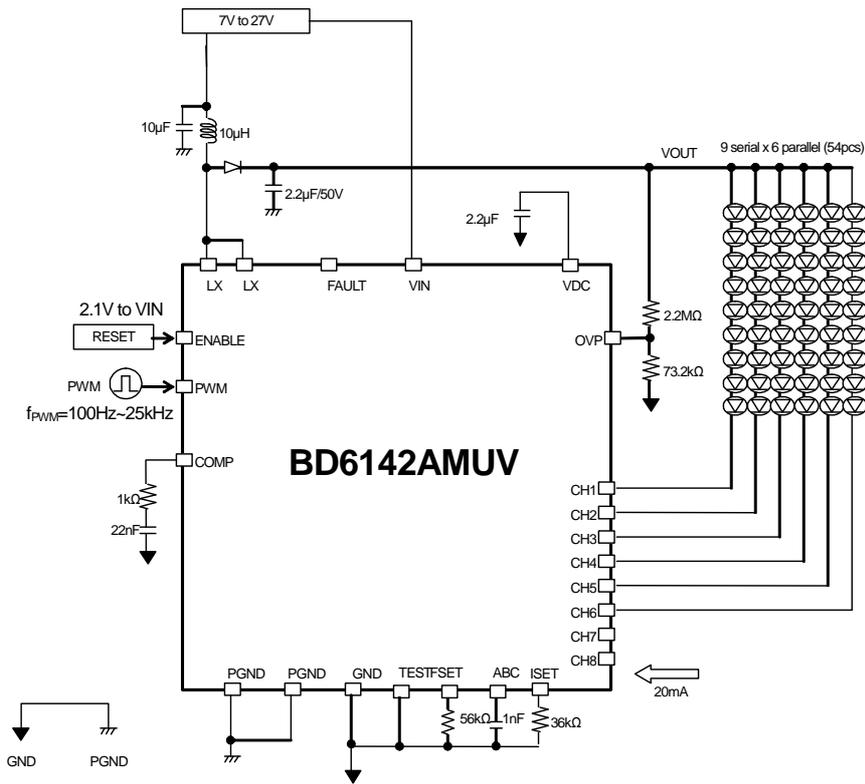


Figure 12. BD6142AMUV Application example (6 parallel)

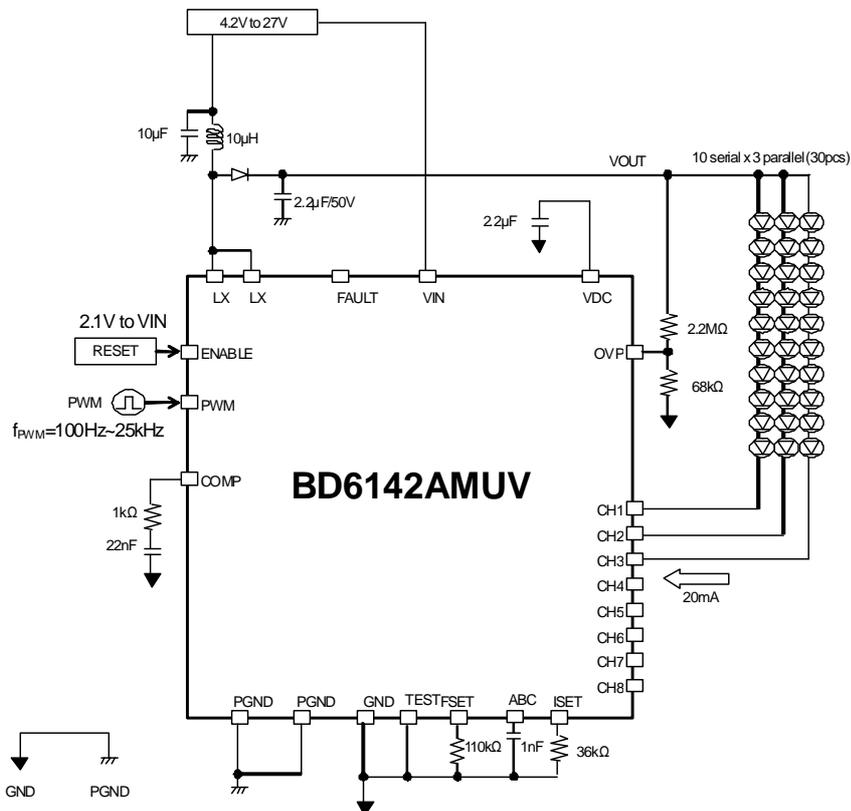


Figure 13. BD6142AMUV Application example (3 parallel)

●機能説明

1) PWM 方式カレントモード DC/DC コンバータ

パワーオン時は CH1,2,3,4,5,6,7,8 のどれか低い電圧を検出し、0.8V になるように PWM duty を決定することで出力電圧を一定に保ちます。PWM 方式カレントモードの特徴である PWM コンパレータの入力は一方がエラーアンプからの誤差成分と、もう一方がサブハーモニック発振防止の Slope 波形にインダクタカレントを制御するカレントセンス信号を重畳したものです。この出力は RS ラッチを経て内蔵 Nch Tr のゲートを制御します。内蔵 Nch Tr のゲートをオンしている期間で、外付けのインダクタにエネルギーを蓄え、内蔵 Nch Tr のゲートがオフしている期間で外付け SBD を通じ出力のキャパシタにエネルギーの移動を行います。
また、この IC は多くの保護機能を有しており、それぞれの検出信号は昇圧動作をすみやかに停止させます。

2) パルススキップコントロール

この IC は昇圧機能として pulse-skip 機能を内蔵しています。入力電圧(コイル電圧)が高く、出力電圧(VOUT)が低い様なアプリケーション時に Pulse-skip 状態になります。この時エラーアンプがスイッチングを止めます。エラーアンプは出力電圧が低くなる、もしくは入力電圧が低くなる場合にスイッチングをスタートさせます。
この IC は Pulse-skip 機能を内蔵しているため過昇圧を防ぎ、スイッチングの損失が少なく、動作電流を最小限に抑えることができます。またエラーアンプでスイッチングが停止している時、入力電圧の負荷はかかりません。この改良された pulse-skip 機能は active-cycle control とも呼ばれています。

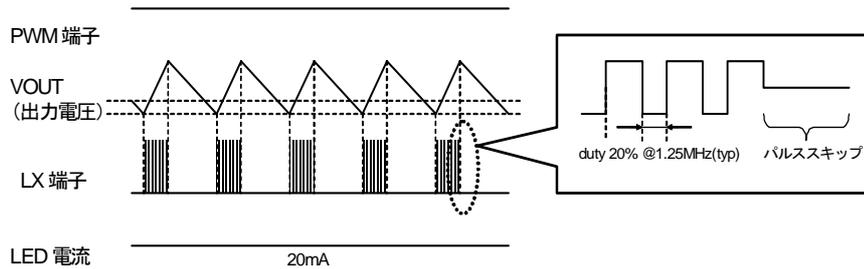


Figure 14. Pulse-skip

3) ソフトスタート

この IC はソフトスタートが内蔵されています。
ソフトスタートはコイルに大電流が流れることを防ぎ、立ち上げ時のラッシュ電流の発生をソフトスタート機能で防ぎます。ENABLE 端子, PWM 端子を L から H に変更した後、UVLO が検出され、4.3ms 以内の間ソフトスタートは有効となり、それ以降 PWM を L から H に変更してもソフトスタートは有効となりません。(P15 のタイミングチャートをご参照ください)



Figure 15. Soft start

4) FAULT

異常状態が発生した場合、保護機能により昇圧動作を停止させ異常状態を回避します。その際、異常状態を FAULT 端子から出力します。パワーオン後、約 4.3ms (typ.) は保護機能が動作しません。ENABLE 端子を H->L にすれば、FAULT 状態がリセットされます。

対象となる保護機能は次のとおりです。

- 過電圧保護 (OVP)
- サーマルシャットダウン (OTP)
- 過電流保護 (OCP)
- 出力ショート保護
- LED ショート(Latch)
- LED オープン(Latch)

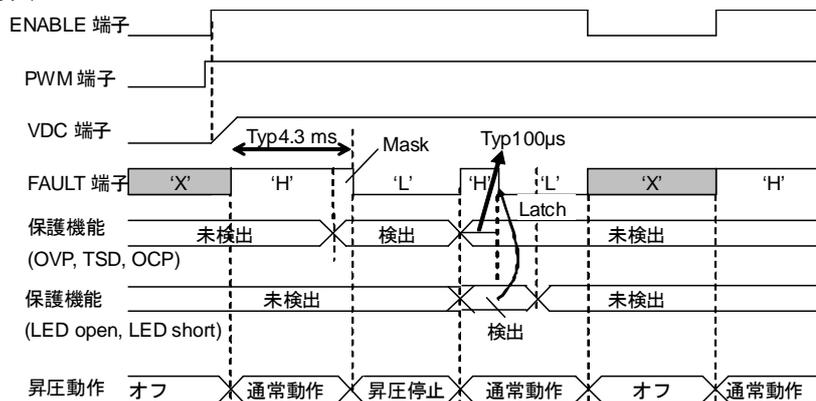


Figure 16. FAULT operating description

●保護機能

保護機能表

CASE	FAILURE MODE	DETECTION MODE	FAIL CHANNEL	GOOD CHANNEL	VOUT REGULATED BY	FAULT Terminal
1	LED ショート CH1 へ接続	CH1 端子>VSC	LED 電流の停止と DC/DC のフィード バックが回復しない	CH2~CH8 通常点灯	CH2~CH8 の 最も高い VF で 調整	'H' → 'L' (Latch)
2	LED オープン CH1 へ接続	CH1 端子<0.2V and OVP 端子< OVP 電圧	LED 電流の停止と DC/DC のフィード バックが回復しない	CH2~CH8 通常点灯	CH2~CH8 の 最も高い VF で 調整	'H' → 'L' (Latch)
3	VOUT/LX 端子を GND へショート	OVP 端子<50mV	FAULT が'H'→'L'に切り替わると、 スイッチが停止する。 OVP>50mV 時, FAULT は'H'に戻る		-	'H' → 'L'
4	出力電圧が 高くなる	OVP 端子< OVP 電圧	FAULT が'H'→'L'に切り替わると、 スイッチが停止する。 OVP<1.2V であっても, FAULT は'H'に戻る (LED open が同時に起こると戻らない)		-	'H' → 'L'
5	LX 電流が多い	OCP > 2.5A or OTP > 130°C	FAULT が'H'→'L'に切り替わると、 スイッチが停止する IC が通常状態に戻ると, FAULT は'H'に戻る		-	'H' → 'L'

・過電圧保護 (OVP)

DC/DC 出力(VOUT)と LED が切り離される様な出力オープン時の異常時に、過昇圧により LX 端子と OVP 端子が絶対最大定格を超えることで IC が破壊する恐れがあります。そこで、OVP 端子が検出電圧以上になると過電圧保護が動作することにより DC/DC の昇圧を停止します。

例えば CH1 端子と CH2 端子が接続されているアプリケーションにおいて CH1 端子の電圧が CH2 端子の電圧より低い条件で、CH1 に接続されている LED が open になると、IC は動作状態から非動作時状態へ変わり、出力電圧(VOUT)はゆっくり低下して CH2 でフィードバックがかかり安定します。

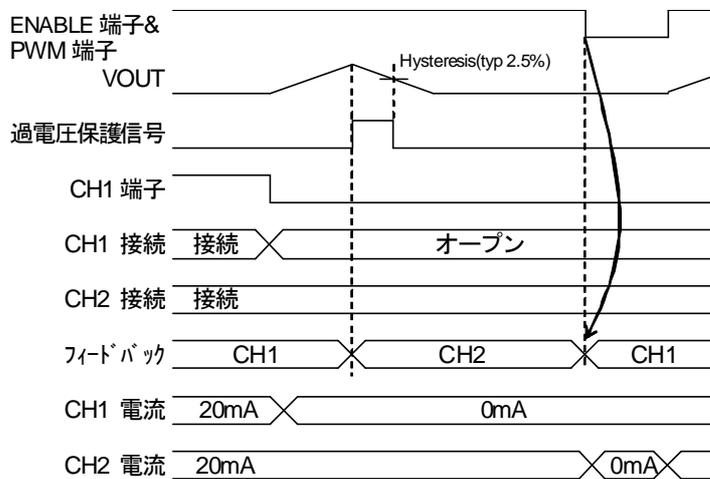


Figure 17. OVP operating description

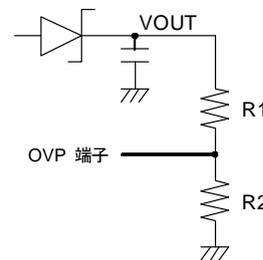
電氣的特性に示しております値を使用しますので、抜粋してこちらに記載します。

過電圧リミット(OVP 検出電圧)	min 1.16V	typ 1.20V	max 1.24V
LED 制御電圧	min 0.64V	typ 0.80V	max 0.96V
LED 端子過電圧保護	min 4.25V	typ 5.00V	max 5.75V

- LED の VF の合計値が最大となる条件を算出します。
例) LED 8 直列, LED の VF=2.9V(min), 3.2V(typ.), 3.5V(max)
"LED の VF の合計値(max)" = 3.5V x 8=28V
- 出力電圧(VOUT)の最大値を次の式で算出します。
"出力電圧の最大値" = LED の VF の合計値(max)" + "LED 制御電圧(max=0.96V)"
例) "出力電圧の最大値" = 28V + 0.96V =28.96V
- 過電圧設定値(min)が"出力電圧の最大値"を上回るように設定します。
"過電圧設定値(min)"と"出力電圧の最大値"が近すぎると、リップルやノイズ等で過電圧を検出してしまふ恐れがあります。
"過電圧設定値(min)"と"出力電圧の最大値"の差にマージンをとる事を推奨しております。
今回は 6%程度のマージンをとりました。
例) "出力電圧の最大値" = 28.96V に対して "過電圧設定値(min)" = 28.96V×1.06=30.70V
IC の過電圧の min=1.16V,typ=1.20V, max=1.24V より
typ 設定値 = 30.70V×(1.20V/1.16) = 31.76V
max 設定値 = 31.76V×(1.26V/1.20V) = 33.35V
- 過電圧設定抵抗値(R1, R2)の調整方法は次のとおりです。
OVP 端子 - VOUT 間の抵抗(R1)を高抵抗に固定し、OVP 端子 - GND 間の抵抗値(R2)を変更して過電圧値を設定してください。これらの抵抗値(R1,R2)が低いと PWM 端子=L 時に出力電圧が低下するため、出力電圧のリップルが大きくなります。(出力コンデンサの音鳴りが大きくなります。)
例) OVP 抵抗(R1, R2)の選定.

・ OVP 抵抗の選定

- (例 1) VF=3.5V max, serial = 7 LEDs
OVP 検出電圧 = 1.2V, R1 = 2.2MΩ, R2 = 95.3kΩ
VOUT = 1.2 × (2.2MΩ + 95.3kΩ) / 95.3kΩ = 28.90V
- (例 2) VF=3.5V max, serial = 8 LEDs
OVP 検出電圧 = 1.2V, R1 = 2.2MΩ, R2 = 82kΩ
VOUT = 1.2 × (2.2MΩ + 82kΩ) / 82kΩ = 33.40V
- (例 3) VF=3.5V max, serial = 9 LEDs
OVP 検出電圧 = 1.2V, R1 = 2.2MΩ, R2 = 73.2kΩ
VOUT = 1.2 × (2.2MΩ + 73.2kΩ) / 73.2kΩ = 37.27V
- (例 4) VF=3.5V max, serial = 10 LEDs
OVP 検出電圧 = 1.2V, R1 = 2.2MΩ, R2 = 68kΩ
VOUT = 1.2 × (2.2MΩ + 68kΩ) / 68kΩ = 40.02V



・ 外付け SBD 外れ保護と出力ショート保護

DC/DC 出力(VOUT)と外付け SBD の接続がオープンになった場合や VOUT が GND とショートした場合にコイル又は内部 Tr が破壊する恐れがあります。その為 OVP 端子電圧が 50mV(typ.)以下の場合に出力 Tr をオフさせます。その結果 ENABLE=L → H 時(起動時)にこの検出をすると、昇圧しない為コイルや IC の破壊を防ぎます。

・ サーマルシャットダウン

この IC にはサーマルシャットダウン機能が内蔵されています。
サーマルシャットダウンは 130°C(typ.)以上で作動し、IC は動作時から非動作時状態へ変わります。

●アプリケーション不具合の動作

1) 動作中 LED が一個又は一列 OPEN になった場合

OPEN となった LED 列は点灯しませんが、他の LED 列は点灯します。

その際、LED 端子が 0V になるため出力が過電圧保護電圧まで昇圧します。過電圧保護が検出された後オープンした列が OFF する事により出力電圧(VOUT)は通常電圧に戻ります。

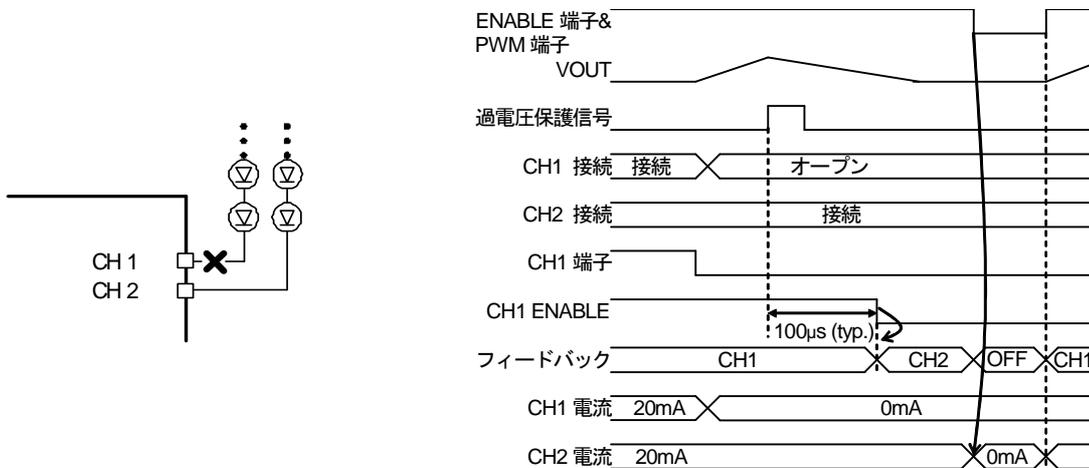


Figure 18. LED open protect

2) LED が複数個ショートした場合

通常昇圧中に任意の CHn(n=1,2,3,4,5,6,7,8)が 5V(typ.)以上になると、5V 以上になるとショートした列だけ消灯し、他の列の LED 電流は正常に点灯し続けます。

ショートした列の(CH1)電流は 20mA から 0.05mA(typ.)に減るため、CH1 端子は熱を持ちません。

使用中の全 CHn(n=1,2,3,4,5,6,7,8)端子の電圧が上がると、Pulse-skip が起こり端子電圧が下がる事によって安定状態へ戻ります

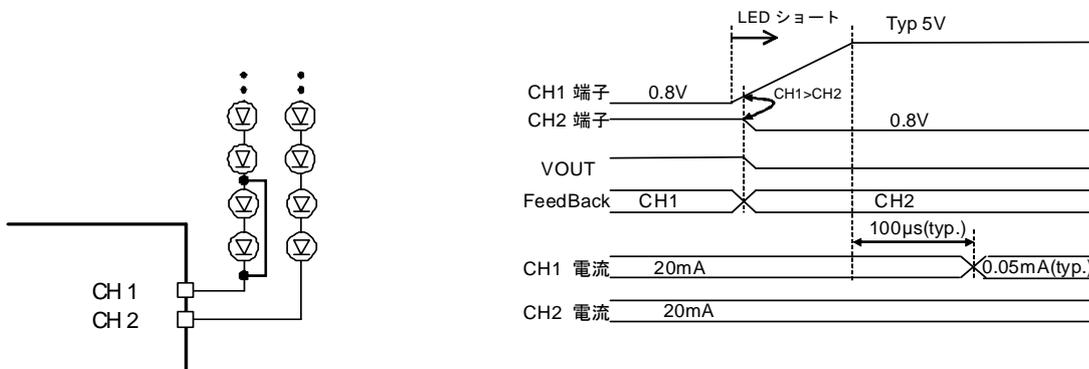


Figure 19. LED short protect

3) ショットキーダイオードが外れた場合

すべての LED は点灯しません。また、ショットキーダイオード外れ保護機能により昇圧動作が停止する為 IC は破壊しません。

●コントロール信号入力タイミング

タイミングシーケンス 1

Figure 20.は Power ON シーケンスです。VIN ON 後 ENABLE 端子 と PWM 端子を'L'から'H'にします。Power OFF シーケンスは ENABLE 端子と PWM 端子を'H'から'L'にした後 VIN OFF します。

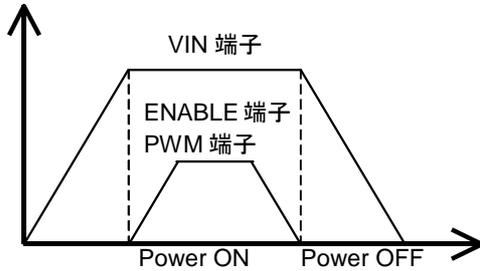
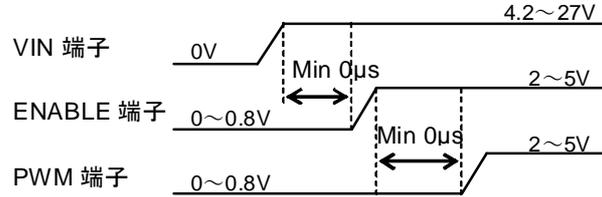


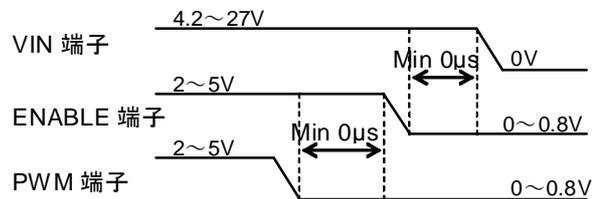
Figure 20. タイミングシーケンス 1

PWM Control Turn-on LED IC タイミングシーケンス



*他の信号は信号がオンになった後入力されます

PWM Control Turn-off LED IC タイミングシーケンス



*他の信号は信号がオフになった後入力されます。

タイミングシーケンス 2

Figure 21.は Power ON シーケンスです。VIN ON 後 ENABLE 端子を'L'から'H'にした後、PWM 端子を'L'から'H'にします。Power OFF シーケンスは PWM 端子を'H'から'L'にした後、VIN OFF, ENABLE 端子を'H'から'L'にします。

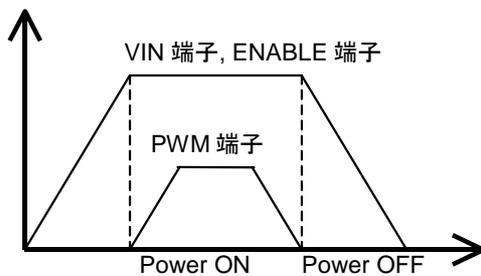
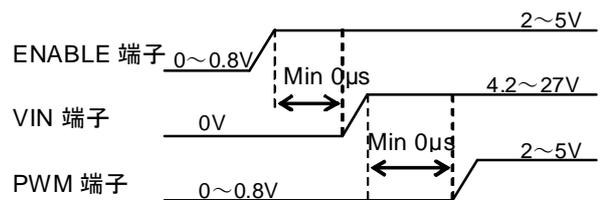


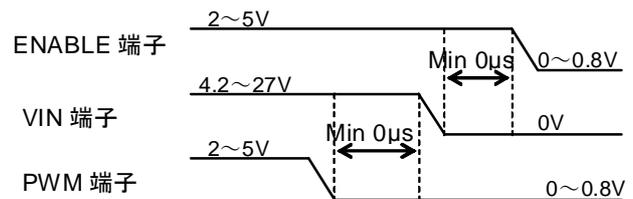
Figure 21. タイミングシーケンス 2

PWM Control Turn-on LED IC タイミングシーケンス



*他の信号は信号がオンになった後入力されます。

PWM Control Turn-off LED IC タイミングシーケンス



*他の信号は信号がオフになった後入力されます。

タイミングシーケンス 3

Figure 22.は Power ON シーケンスです。VIN ON 後 PWM 端子を'L'から'H'にした後、ENABLE 端子を'L'から'H'にします。Power OFF シーケンスは PWM 端子を'H'から'L'にした後、VIN OFF, ENABLE 端子を'H'から'L'にします。

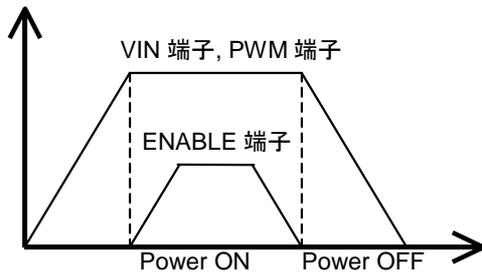
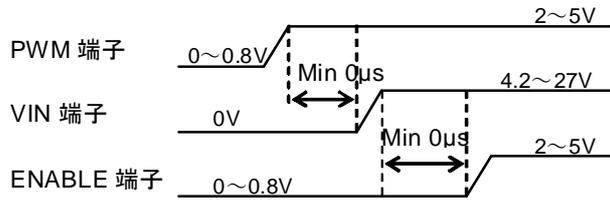


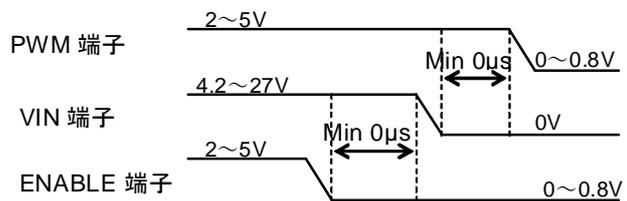
Figure 22. タイミングシーケンス 3

ENABLE Control Turn-on LED IC タイミングシーケンス



*他の信号は信号がオンになった後入力されます。

ENABLE Control Turn-off LED IC タイミングシーケンス



VIN 立ち上がりスピード

*他の信号は信号がオフになった後入力されます。

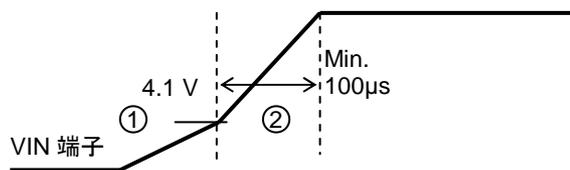


Figure 23. コントロール信号タイミング

PWM 端子を 10ms 以上 L とする場合、Figure 24.のように ENABLE 端子をリセット('H' -> 'L')します。PWM 端子が OFF し出力電圧が低下した場合に、この IC は再スタート時に過電流状態になります(ソフトスタートではない)。ソフトスタートが必要ない場合はリセットする必要はありません。

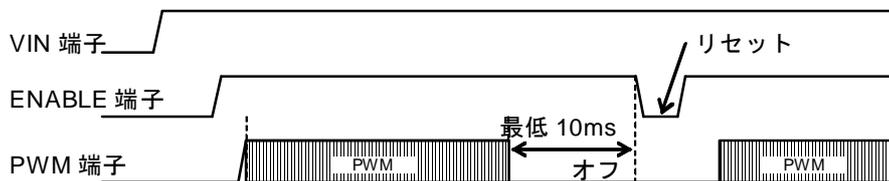


Figure 24. PWM 停止・ENABLE リセット

●起動方法

起動時は以下のことに注意してください。

- ENABLE 端子 L->H 後レギュレータ (VDC)が動作します。UVLO 解除後内部回路は動作します。UVLO 解除後昇圧する時はソフトスタート機能が動作します(P9, Figure 15.参照)。ソフトスタート回路は Figure 25.のように t_{15} (15 μ s 以上) が必要です。ソフトスタートは t_{soft} 時間動作します。ソフトスタート終了までは PWM 端子の H 幅を 15 μ s 以上にしてください。
- ソフトスタート終了後は Figure 26.にしたがって PWM 信号を入力してください。

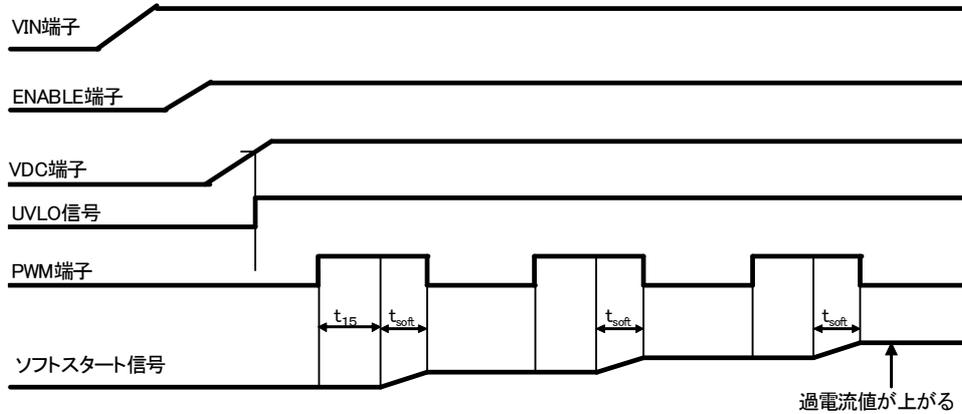


Figure 25. ソフトスタート

例) PWM 周波数 25kHz, PWM=H 時間 16 μ s 時のソフトスタート終了までの時間

ソフトスタート時間 typ4.3ms より

$$t_{soft} = 16\mu s - 15\mu s = 1\mu s$$

$$\text{ソフトスタート時間} / t_{soft} / \text{PWM 周波数} = 4300\mu s / 1\mu s / 25\text{kHz} = 4300 / 25\text{kHz} = 172\text{ms}$$

PWM 端子での調光時(ソフトスタート終了後)

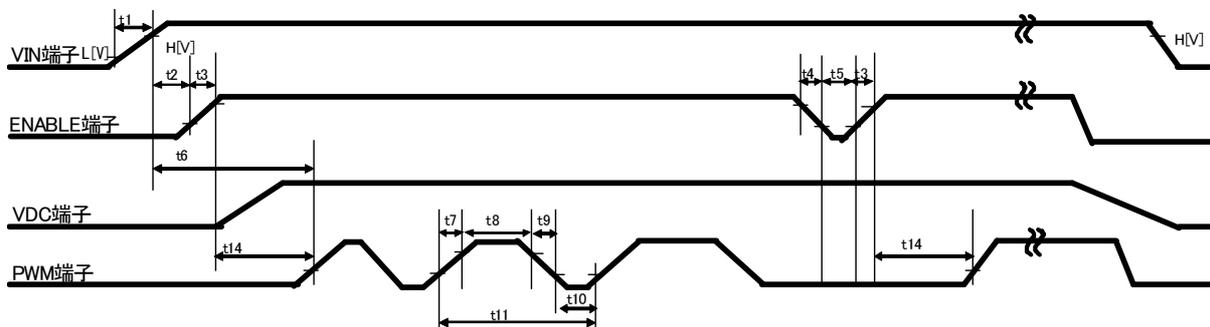


Figure 26. 入力タイミング (ソフトスタート後)

	Name	Unit	Min.	Typ.	Max.
t1	電源立ち上がり時間	μ s	100	-	-
t2	電源 - ENABLE 時間	μ s	0	-	-
t3	ENABLE 立ち上がり時間	μ s	0	-	100
t4	ENABLE 立ち下がり時間	μ s	0	-	100
t5	ENABLE ロー幅	μ s	50	-	-
t6	電源 - PWM 時間	μ s	0	-	-
t7	PWM 立ち上がり時間	μ s	0	-	100
t8	PWM ハイ幅	μ s	5	-	-
t9	PWM 立ち下がり時間	μ s	0	-	100
t10	PWM ロー幅	μ s	5	-	-
t11	PWM 周波数	μ s	40	5000	10000
t12	ENABLE (H) → PWM (H)時間	μ s	0	-	-
t13	ENABLE (L) → PWM (L)時間	μ s	0	-	-
t14	PWM (L) → ENABLE (L)時間	μ s	0	-	-
t15	PWM ハイ幅 (ソフトスタート中)	μ s	15	-	-
H	動作電圧	V	4.2	12	27
L	非動作電圧	V	-	-	4.2

●カレントドライバの列数選択方法

カレントドライバの列数を減らしたい場合、不要なCH1~8の端子をオープンすることで、未選択にできます。6列などで使用する場合は不要な2列をオープンにすることで対応できます。

ENABLE 端子と PWM 端子を L->H 後 OVP 電圧まで VOUT は昇圧します。一旦 IC が OVP を検出すると、OVP が解除されるまで昇圧しません。ENABLE 端子と PWM 端子を L に設定すると、IC は Figure 27.のように CH7, 8 をリセットします。また CH8(オープン端子)と CH1 が Figure 28.のように選択されます。

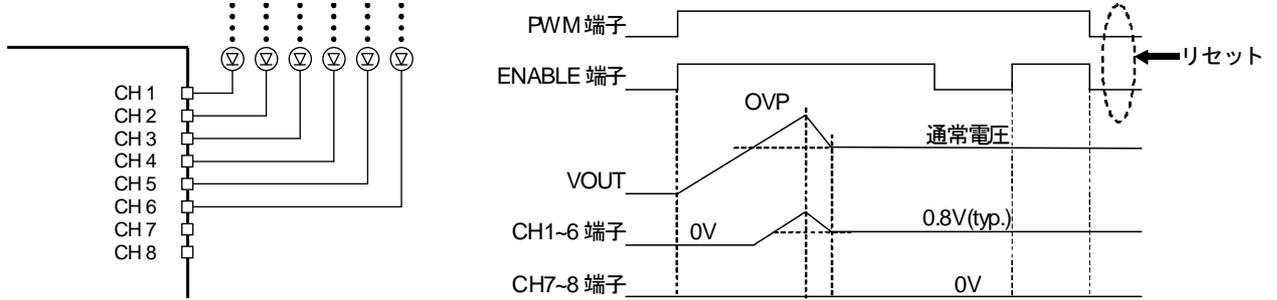


Figure 27. CH1 の列数選択

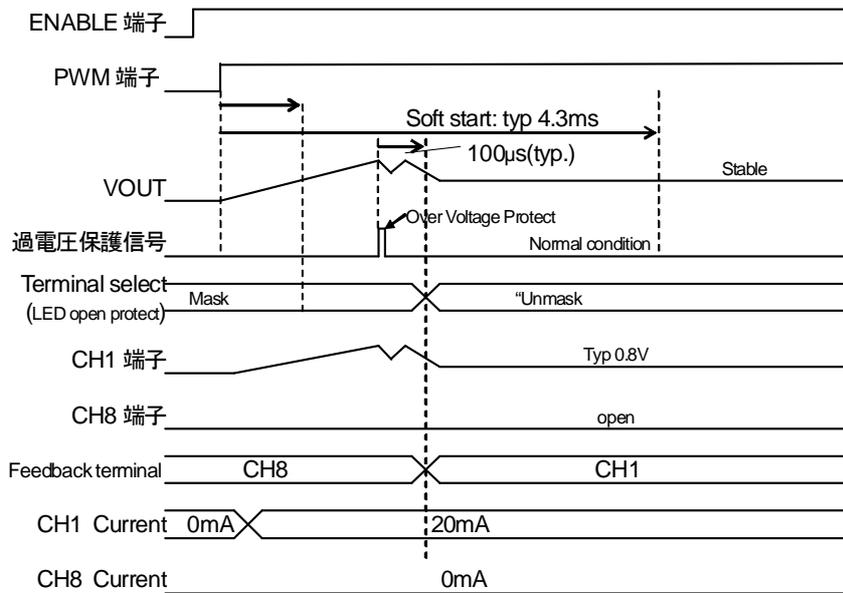


Figure 28. CH2 の列数選択 (起動時)

●起動制御(ENABLE)と LED 電流の選択(PWM)

この IC は ENABLE 端子により IC のパワーをコントロールでき、0.8V 以下で IC を強制的にパワーオフさせることができます。また、ENABLE 端子が 2.0V 以上の時パワーオンになります。
ENABLE 端子=H の時、PWM 端子=H で ISET 抵抗値により決まる LED 電流が流れます。
PWM=L とすると、LED 電流は停止します。

ENABLE	PWM	IC	LED 電流
0	0	Off	OFF
1	0	On	OFF
0	1	Off	OFF
1	1	On	ISET で決定される電流

●LED 電流設定範囲

ISET の電圧に接続する抵抗(RISET)によって通常電流が設定されます。
各設定電流は次のように与えられます。

$$RISET = 720 / I_{LEDmax}$$

なお、通常電流の設定範囲は 10~30mA までで、オフ設定時の LED 電流はリーク電流最大 2μA となります。

ISET 通常電流設定例

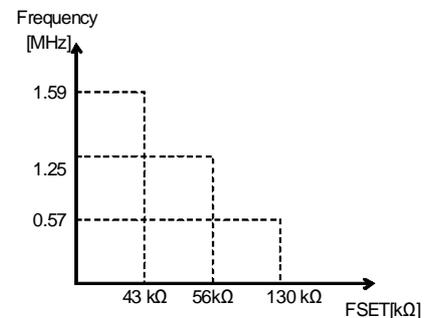
RISET	LED 電流
24kΩ(E24)	30.0mA
30kΩ(E24)	24.0mA
36kΩ(E24)	20.0mA
43kΩ(E24)	16.7mA
68kΩ(E12)	10.6mA

●周波数設定範囲

スイッチング周波数を FSET 端子に接続する抵抗で設定できます。
下記の表は FSET 端子に抵抗をつけた場合の参考データです。
周波数範囲は 0.60MHz~1.60MHz の間で設定してください。

FSET 周波数設定例

RFSET	周波数
130kΩ(E96)	0.57MHz
56kΩ(E24)	1.25MHz
43kΩ(E24)	1.59MHz



最大デューティ例

周波数	最大デューティ[%]		
	Min	Typ	Max
0.57MHz	-	96.0	-
1.25MHz	91.0	95.0	99.0
1.59MHz	-	92.0	-

最小デューティ例

周波数	最小デューティ[%]		
	Min	Typ	Max
1.25MHz	-	20	-

●PWM 調光

カレントドライバ PWM 調光は Figure 29.で示されるとおり PWM 端子に PWM 信号を与えることにより行われます。Figure 29.のように PWM 端子の H 区間は ISET で設定した電流が選ばれ、L 区間は電流をオフします。すなわち、平均 LED 電流は PWM 信号の Duty サイクルに比例して増加することになります。この方法は内部回路や DC/DC を動作させながら、ドライバの切り替えとなるため PWM 輝度調整時の電流ばらつきが少なく、5 μ s(200Hz 時に最低 0.1%)までの輝度調整を可能とします。なお、オン時間 1 μ s 未満とオフ時間 1 μ s 未満は、オン/オフの切り替えの影響が大きいため、輝度調整には使用しないでください。標準 PWM 周波数は 100Hz~25kHz です。

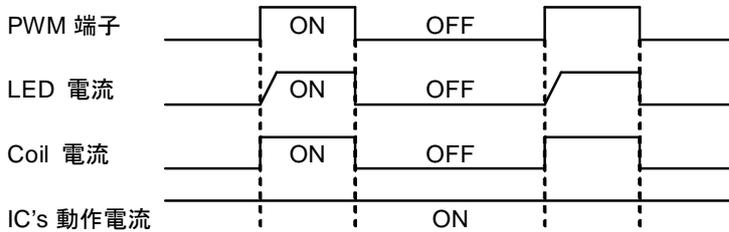
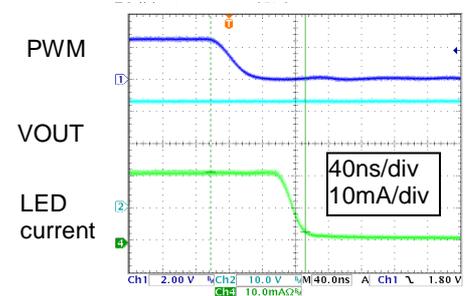
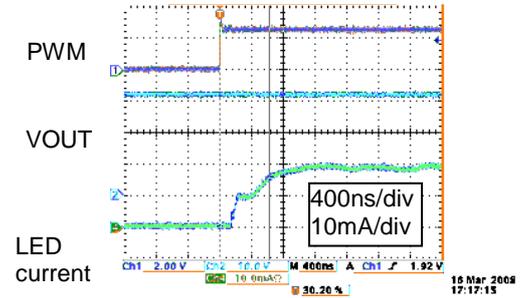


Figure 29. PWM sequence

条件： 8serial 6parallel, LED current=20mA/ch,
VIN=7V, Ta=25°C, 出力コンデンサ=2.2 μ F(50V/B3)



●アナログ調光

この IC はアナログ入力(ABC 端子)で LED 電流を制御できます。LED 電流は ISET に接続された抵抗で決まります。その通常状態が ABC voltage = 0.733V(typ.)です
これに対して ABC 電圧を変えることにより設定電流を増減させます。

LED 電流の最大値は P.17 の LED 電流の設定範囲に従ってください。
設定 LED 電流の最大値が ABC voltage=0.733V(typ.)であることを注意してください。
ABC 端子の入力範囲は 0.05V~0.9V(Target)です。
この輝度制御は ISET の精度に影響を受けます。

アナログ輝度制御をしない時は ABC 端子にコンデンサを接続してください。 Figure 30. アナログ調光アプリケーション
コンデンサを接続した場合 ABC 端子のチャージが終わるまで LED 電流はその時定数で増加します。

内部バイアス 1.2V と ABC 端子間の抵抗は 120.9k Ω (typ.)です。
時定数を考慮してコンデンサ値を決めてください。

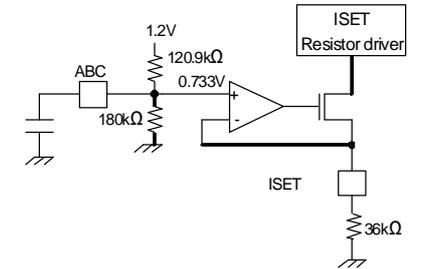
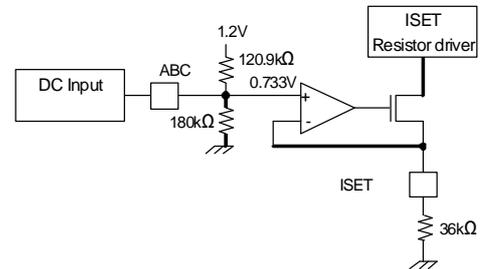


Figure 31. PWM 調光アプリケーション

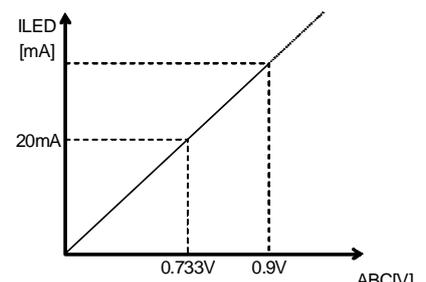


Figure 32. ILED – ABC 電圧

●コイルの選択

この DC/DC は 4.7μH 以上で設計されております。L 値を低くすると、カレントモード DC/DC 特有のサブハーモニック発振の可能性があります。L 値が 3.3μH 以下にならないようにしてください。また、L 値を増加させると DC/DC の位相余裕がなくなります。L 値を増やす場合は出力コンデンサ値を大きくしてください。インダクタの効率を上げるために、抵抗成分(DCR)を小さくする必要があります。また以下の見積もり例のように、コイルのピーク電流を見積もってください。

ピーク電流の見積もり

<通常動作に必要な電流値の見積もり>

この IC の過電流検出器はピーク電流を検出しているため、コイルに流れるピーク電流を使用条件によって見積もる必要があります。各変数を以下のように定義します。

- コイルの電源電圧 = V_{in}
- スイッチング周波数 = fsw (Min=1.0MHz, Typ = 1.25MHz, Max = 1.5MHz)
- 出力電圧 = V_{OUT}
- コイルの平均電流 = I_{ave}
- スイッチング周期 = T
- スイッチングトランジスタのオン時間 = T_{on}
- コイルのインダクタンス値 = L
- Total の LED 電流 = I_{LED}
- コイルのピーク電流 = I_{peak}
- 効率 = eff (マージンを持って設定してください。)
- ON Duty = D

CCM: $I_{peak} = (V_{in} / L) \times (1 / fsw) \times (1 - (V_{in} / V_{OUT}))$, DCM: $I_{peak} = (V_{in} / L) \times T_{on}$

$I_{ave} = (V_{OUT} \times I_{OUT} / V_{in}) / eff$

$T_{on} = (I_{ave} \times (1 - V_{in} / V_{OUT}) \times (1 / fsw) \times (L / V_{in}) \times 2)^{1/2}$

関係式は以下のようになります。

ピーク電流は(CCM/DCM)であるかで変わります。各モード時のピーク電流は以下のようになります。

CCM: $(1 - V_{in} / V_{OUT}) \times (1 / fsw) < T_{on} \rightarrow peak\ current = I_{peak} / 2 + I_{ave}$

DCM: $(1 - V_{in} / V_{OUT}) \times (1 / fsw) > T_{on} \rightarrow peak\ current = V_{in} / L \times T_{on}$

(例 1)

In case of, $V_{in} = 7.0V$, $L = 10\mu H$, $fsw = 1.2MHz$, $V_{OUT} = 32V$, $I_{LED} = 120mA$, Efficiency = 88%とした場合、

$I_{ave} = (32 \times 120m / 7) / 88\% = 0.62A$

$T_{on} = (0.62 \times (1 - 7 / 32) \times (1 / 1.2M) \times (10\mu / 7) \times 2)^{1/2} = 1.07\mu s$

$(1 - V_{in} / V_{OUT}) \times (1 / fsw) = 0.65\mu s < T_{on}(1.07\mu s)$ CCM

$I_{peak} = (7 / 10\mu) \times (1 / 1.2M) \times (1 - (7 / 32)) = 0.46A$

ピーク電流 = $0.46A / 2 + 0.62A = 0.85A$

(例 2)

In case of, $V_{in} = 16.0V$, $L = 10\mu H$, $fsw = 1.2MHz$, $V_{OUT} = 32V$, $I_{LED} = 120mA$, Efficiency = 88%とした場合、

$I_{ave} = (32 \times 120m / 16.0) / 88\% = 0.27A$

$T_{on} = (0.27 \times (1 - 16 / 32) \times (1 / 1.2M) \times (10\mu / 16) \times 2)^{1/2} = 0.37\mu s$

$(1 - V_{in} / V_{OUT}) \times (1 / fsw) = 0.41\mu s > T_{on}(0.37\mu s)$ DCM

$I_{peak} = V_{in} / L \times T_{on} = 16 / 10\mu \times 0.37\mu s = 0.59A$

ピーク電流 = 0.59A

DCM/CCM の見積もり

不連続モード(DCM) 及び連続モード (CCM) は以下のとおり算出されます。

CCM: $L > V_{OUT} \times D \times (1 - D)^2 \times T / (2 \times I_{LED})$

DCM: $L < V_{OUT} \times D \times (1 - D)^2 \times T / (2 \times I_{LED})$

* $D = 1 - V_{in} / V_{OUT}$

(例 1)

In case of, $V_{in} = 7.0V$, $L = 10\mu H$, $fsw = 1.2MHz$, $V_{OUT} = 32V$, $I_{LED} = 120mA$ とした場合、

$V_{OUT} \times D \times (1 - D)^2 \times T / (2 \times I_{LED}) = 32 \times (1 - 7 / 32) \times (7 / 32)^2 \times 1 / (1.2 \times 10^6) / (2 \times 0.12) = 4.15\mu < L(10\mu H)$

→ CCM

(例 2)

In case of, $V_{in} = 12.0V$, $L = 10\mu H$, $fsw = 1.2MHz$, $V_{OUT} = 32V$, $I_{LED} = 60mA$ とした場合、

$V_{OUT} \times D \times (1 - D)^2 \times T / (2 \times I_{LED}) = 32 \times (1 - 12 / 32) \times (12 / 32)^2 \times 1 / (1.2 \times 10^6) / (2 \times 0.06) = 19.5\mu > L(10\mu H)$

→ DCM

●出力コンデンサの選定

出力コンデンサがうまく出力電圧を保ち、LED 電流を補充します。出力電圧は充電(FET ON)と放電(LED 電流)で構成されており、そのため FET スイッチング毎に出力電圧リップルが起こります。

以下は出力電圧リップルの計算例です。

出力電圧リップル

- スイッチング周期 = T
- Switching ON duty = D
- 出力コンデンサ = C_{OUT}
- Decreasing ratio of Capacitor = C_{error}
- Total の LED 電流 = I_{LED}
- 出力リップル電圧 = V_{ripple}
- 出力コンデンサ (real value) = C_{real}

$C_{real} = C_{OUT} \times C_{error}$ (コンデンサ値はバイアスによって減少する。)

$C_{real} = I_{LED} \times (1 - D) \times T / V_{ripple}$

$C_{OUT} = I_{LED} \times (1 - D) \times T / V_{ripple} / C_{error}$

(例 1)

In case of, V_{IN}=12.0V, f_{sw} = 1.2MHz, V_{OUT} =32V, I_{LED} =120mA, C_{OUT} = 8.8μF, C_{error} = 50%とした場合、

$T = 1 / 1.2\text{MHz}$

$D = 1 - V_{IN} / V_{OUT} = 1 - 12/32$

$V_{ripple} = I_{LED} \times (1 - D) \times T / (C_{OUT} \times C_{error}) = 120\text{mA} \times (12/32) / 1.2\text{MHz} / (8.8\mu\text{F} \times 0.5)$
 $= 8.5\text{mV}$

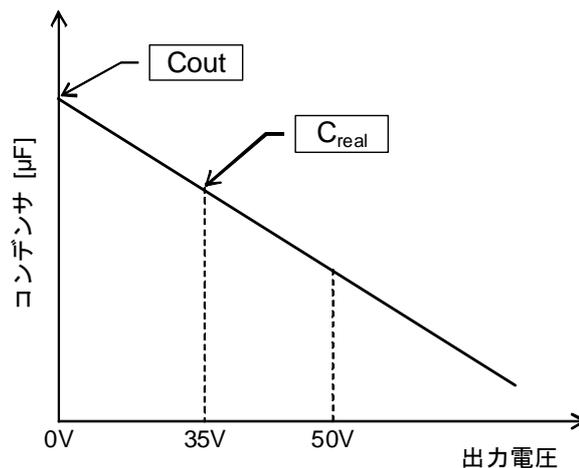


Figure 33. コンデンサのバイアス特性

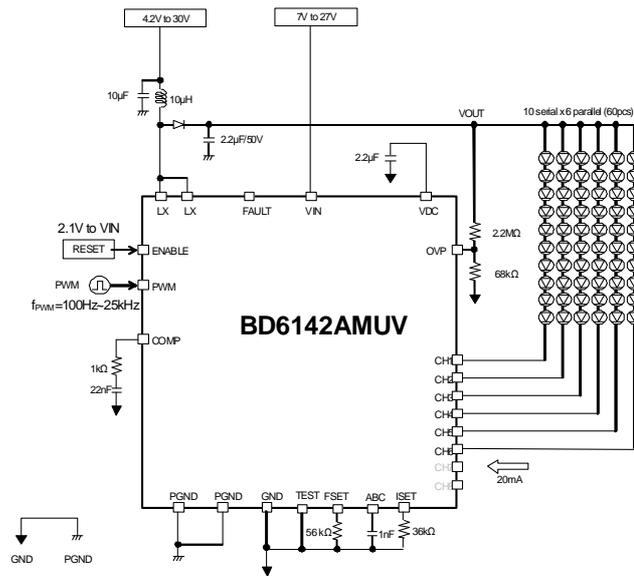
●IC 電源とコイル電源の分離

この IC は IC への電源とコイルへの電源を分けて動作できます。用途として IC の消費電力の低減、IC の定格 27V を超える電圧の印加対応が挙げられます。

そのアプリケーションを Figure 34. に示します。コイルの電源にはアダプターなどから与えられる高い電圧源を接続します。次に、IC の電源としてコイル電源と異なる電源を接続します。IC の VIN に 4.2V から 5.5V を入力する条件では Figure 34. のように VIN 端子と VDC 端子を IC 外部でショートしてご使用ください。

コイル電源が印加され、IC の電源が 0V の状態でも使用上問題ありません。IC の電源が 0V に設定されても IC 内部にコイル電源からのリーク経路を遮断するパワーオフ用のプルダウン抵抗が配置されており、リーク経路を遮断します。また、コイル電源と IC 電源の立ち上げ・立ち下げ順番はございません。

VIN とコイル電源を分離



VIN と VDC 端子に接続

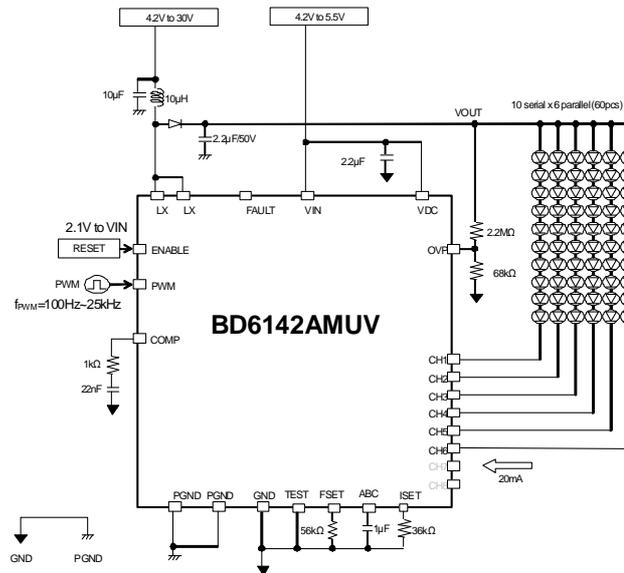


Figure 34. 電源分離時のアプリケーション例

●PCB レイアウト

本 IC の性能を十分に引き出すには PCB レイアウトは非常に重要です。効率やリップルなどの特性はレイアウトパターンにより大きく変化するため、十分注意してください。

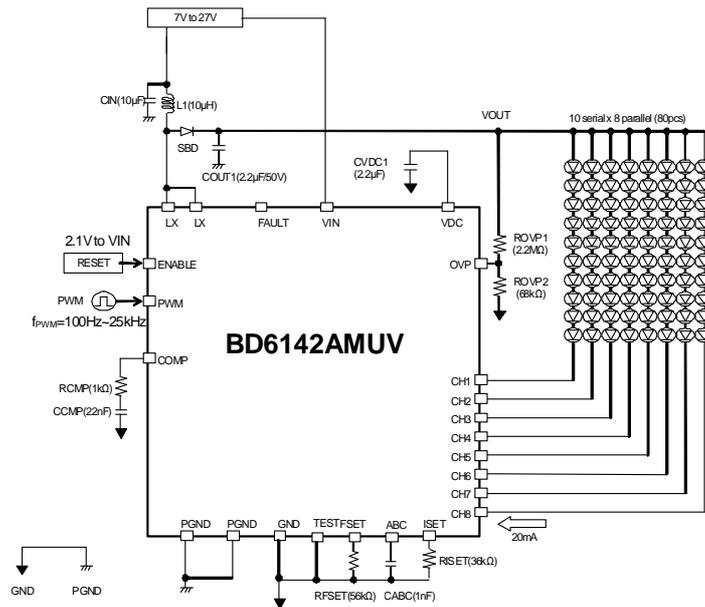


Figure 35. レイアウト図

<コイルの入カバイパスコンデンサ CIN(10µF)>

コイル L1 の直近と PGND の間に接続してください。

<レギュレータの平滑コンデンサ CVDC1(2.2µF)>

VREG ピンと GND の間に直近で接続してください。

<ショットキーバリアダイオード SBD>

コイル L1 と LX ピンの間に直近で接続してください。

<出力コンデンサ COUT1>

SBD のカソードと PGND に接続してください。

その際、CVIN の PGND 側と COUT1 の PGND 側を近づけるように配置してください。

<LED 電流設定抵抗 Riset(36kΩ)>>

ISET ピンの直近と GND の間に接続してください。

ISET 端子に容量がつくと発振する可能性があるため、容量がつかないように注意してください。

<アナログ調光ピン平滑コンデンサ CABC(1nF)>

ABC ピンの近くに配置していただき、配線を引き伸ばさないようにしてください。引き伸ばすとノイズがのり、LED 電流が揺れる恐れがあります。

<周波数設定抵抗 RFSET(56kΩ)>

FSET ピンの直近と GND の間に接続してください。

<過電圧リミット設定抵抗 ROVP1(2.2MΩ)、ROVP2(68kΩ)>

OVP ピンの近くに配置していただき、配線を引き伸ばさないようにしてください。引き伸ばすとノイズがのり、過電圧保護を誤検出する恐れがあります。

<GM アンプ位相保証の設定抵抗 RCMP(1kΩ)、CCMP(1nF)>

COMP ピンの近くに配置していただき、配線を引き伸ばさないようにしてください。引き伸ばすとノイズがのり、発振する恐れがあります。

<GND と PGND の接続>

GND はアナログ・グランドであり、PGND はパワー・グランドです。PGND はコイル電流が流れることからノイズが多くなります。コイルの入カバイパスコンデンサ CVIN と出力コンデンサ COUT1 で平滑化した後、アナログ・グランドに接続するようにしてください。

<裏面の放熱 PAD>

IC の放熱性を高めるために使用する PAD です。アナログ・グランドとなる GND ピンに半田で接続してください。

また、次ページのパターンのようにビアを使用して基板のグランドプレーンに接続してください。

グランドプレーンの面積に応じて放熱性が高まります。

<その他>

チップの直近で上記部品をピンに直接接続しない場合、この IC の性能に影響を与え、電流ドライブ性能を制限する可能性があります。インダクタへの配線は電力消費を減らし、全体効率を上げるため抵抗成分を小さくしてください。これらを考慮したレイアウトパターンを下記に示します。

●推奨 PCB レイアウト

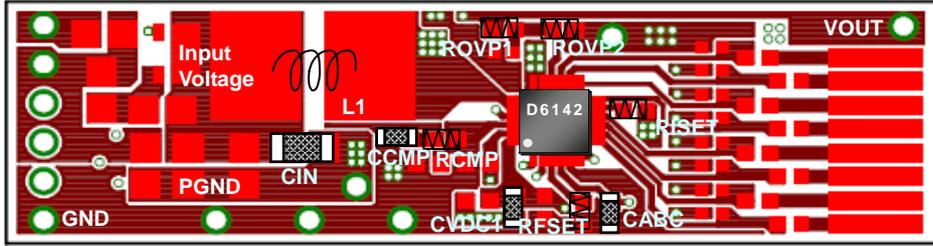


Figure 36. Top Copper trace layer

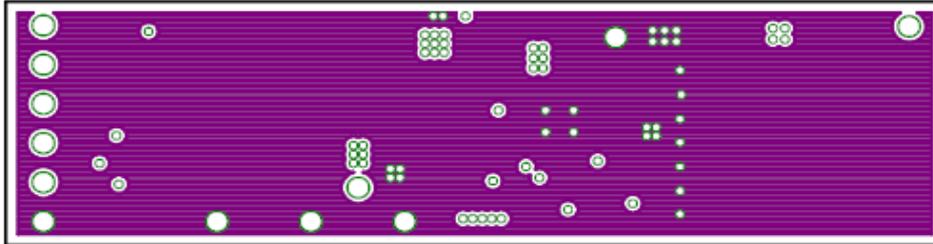


Figure 37. Middle1 Copper trace layer

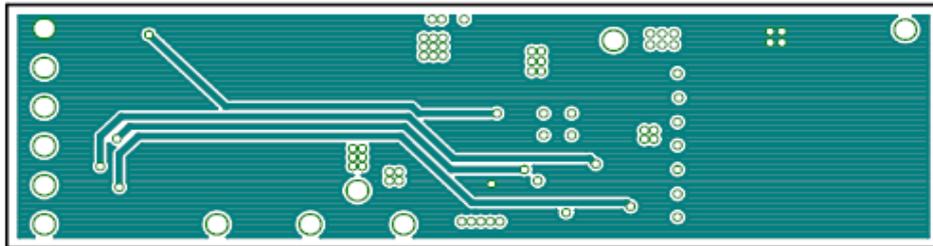


Figure 38. Middle2 Copper trace layer

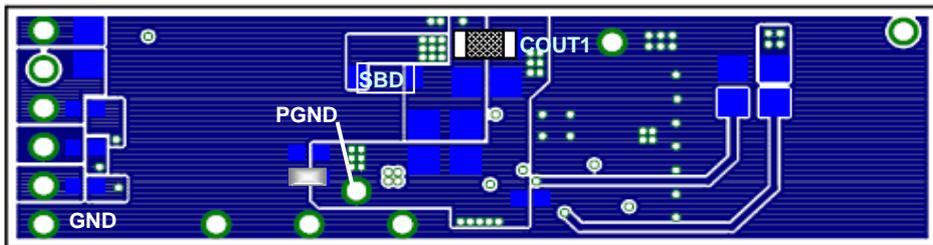


Figure 39. Bottom Copper trace layer

●外付け部品の選定

推奨外付け部品は下のとおりとなります。

これらの部品以外を御使用される場合は下記部品相当品を選んでください。

・コイル

Value	Manufacturer	Product number	Size (mm)			DC current (mA)	DCR (Ω)
			L	W	H (MAX)		
4.7 μ H	TDK	LTF5022T-4R7N2R0-LC	5.0	5.2	2.2	2000	0.073
4.7 μ H	TOKO	A915AY-4R7M	5.2	5.2	3.0	1870	0.045
10 μ H	TOKO	A915AY-100M	5.2	5.2	3.0	1400	0.140
10 μ H	TDK	LTF5022T-100M1R4-LC	5.0	5.2	2.2	1400	0.140
10 μ H	TOKO	B1047AS-100M	7.6	7.6	5.0	2700	0.053

・コンデンサ

Value	Pressure	Manufacturer	Product number	Size		
				L	W	H
10 μ F	25V	MURATA	GRM31CB31E106KA75	3.2	1.6	1.6
4.7 μ F	25V	MURATA	GRM319R61E475K	3.2	1.6	0.85 \pm 0.1
2.2 μ F	50V	TDK	C3225JB1H225K	3.2	2.5	2.0 \pm 0.2
2.2 μ F	50V	MURATA	GRM31CB31H225K	3.2	1.6	1.6
2.2 μ F	50V	Panasonic	ECJHVB1H225K	3.2	1.6	0.85
2.2 μ F	10V	MURATA	GRM188B31A225K	1.6	0.8	0.8
0.1 μ F	50V	MURATA	GRM188B31H104K	1.6	0.8	0.8
0.1 μ F	10V	MURATA	GRM188B31A104K	1.6	0.8	0.8
0.022 μ F	10V	MURATA	GRM155B31H223K	1.0	0.5	0.5
470pF	50V	MURATA	GRM155B11H471K	1.0	0.5	0.5

・抵抗

Value	Tolerance	Manufacturer	Product number	Size (mm)		
				L	W	H
2.2M Ω	\pm 1.0%	ROHM	MCR03PZPZFX2204	1.6	0.8	0.45
91k Ω	\pm 0.5%	ROHM	MCR03PZPZD9102	1.6	0.8	0.45
75k Ω	\pm 0.5%	ROHM	MCR03PZPZD7502	1.6	0.8	0.45
68k Ω	\pm 0.5%	ROHM	MCR03PZPZD6802	1.6	0.8	0.45
56k Ω	\pm 0.5%	ROHM	MCR03PZPZD5602	1.6	0.8	0.45
36k Ω	\pm 0.5%	ROHM	MCR03PZPZD3602	1.6	0.8	0.45
10k Ω	\pm 1.0%	ROHM	MCR03PZPZF103	1.6	0.8	0.45
1k Ω	\pm 0.5%	ROHM	MCR03PZPZD1002	1.6	0.8	0.45
330 Ω	\pm 0.5%	ROHM	MCR03PZPZD3300	1.6	0.8	0.45

・SBD

Pressure	Manufacturer	Product number	Size (mm)		
			L	W	H
60V	ROHM	RB160M-60	3.5	1.6	0.8

コイルは効率に最も影響を与える部品です。直流抵抗(DCR)が小さく、電流インダクタンス特性が良い部品を選んでください。インダクタンス値は10 μ Hで設計されております。3.3 μ Hより低いインダクタンス値は使用しないでください。コンデンサはセラミックタイプの周波数・温度特性の良いタイプで、直流抵抗成分(DCR)の小さい部品を選択してください。

●熱損失について

熱設計において、次の条件内で動作させてください。

(下記温度は保証温度ですので、必ずマージンなどを考慮してください。)

1. 周囲の温度 T_a が 85 $^{\circ}$ C以下であること。
2. IC の損失が許容損失 P_d 以下であること。

●アプリケーション例

- 1. ESD とフリッカー (起動(duty 5% @200Hz))
 LED 電流: 20mA (ISET = 36kΩ)
 LED: 10 直列×3 並列

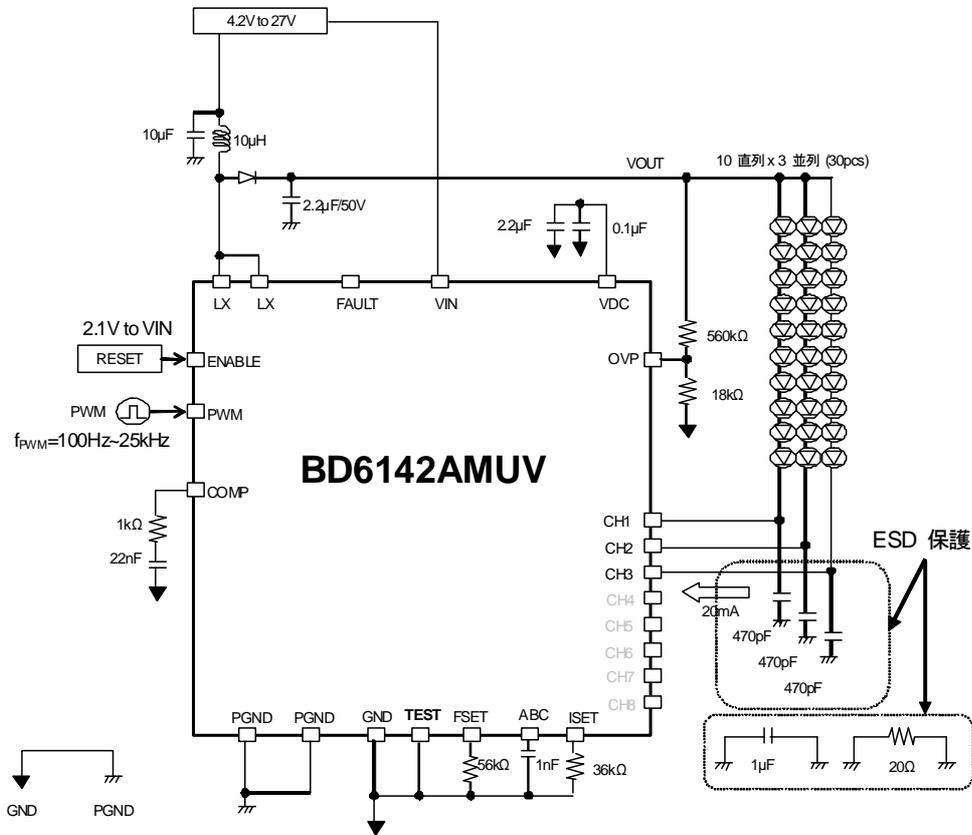


Figure 40. 10 インチパネル アプリケーション例

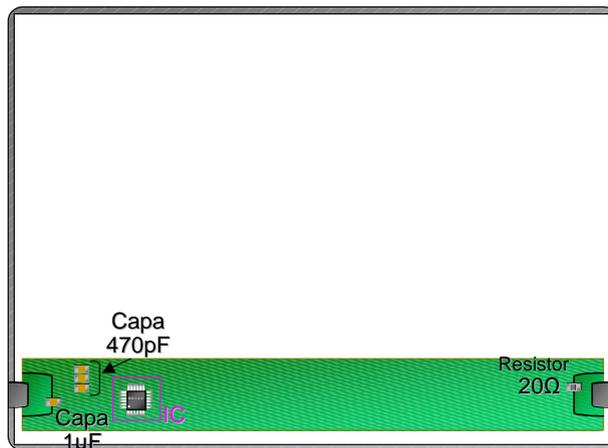


Figure 41. ESD 保護 レイアウト例

2. アナログ調光と FAULT 端子モニター
 LED 電流: 20mA (ISET = 36kΩ)
 LED: 10 直列×8 並列

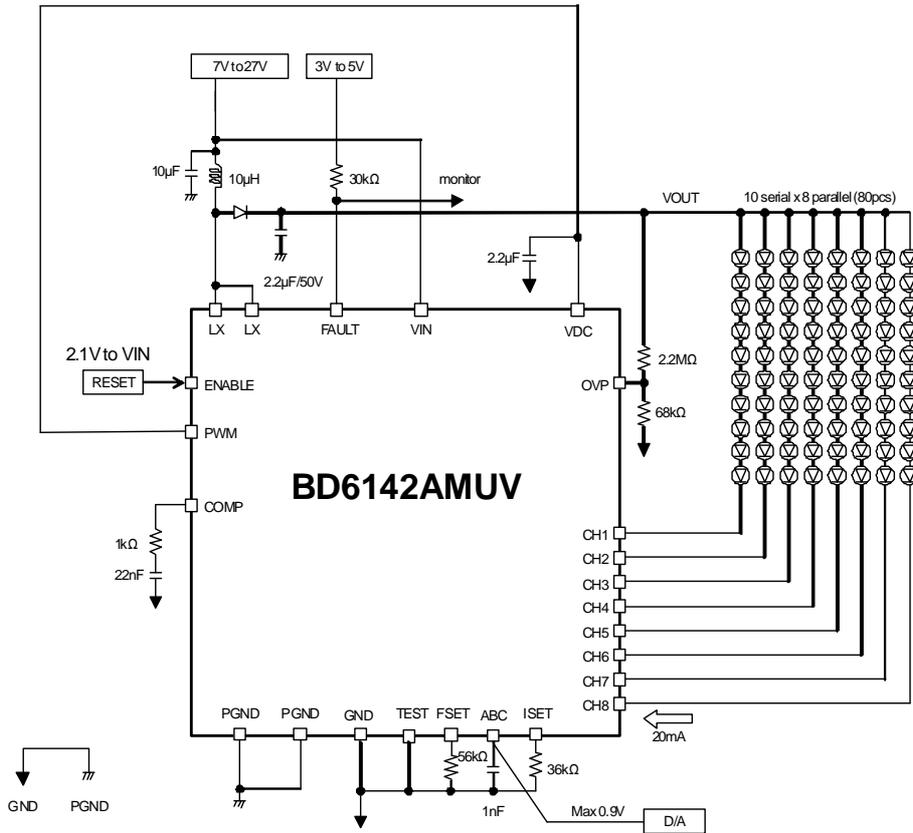


Figure 42. アナログ調光のアプリケーション例

3. CH 端子ショートアプリケーション
 LED 電流: 20mA (ISET = 36kΩ)
 LED: 3 直列×12 並列

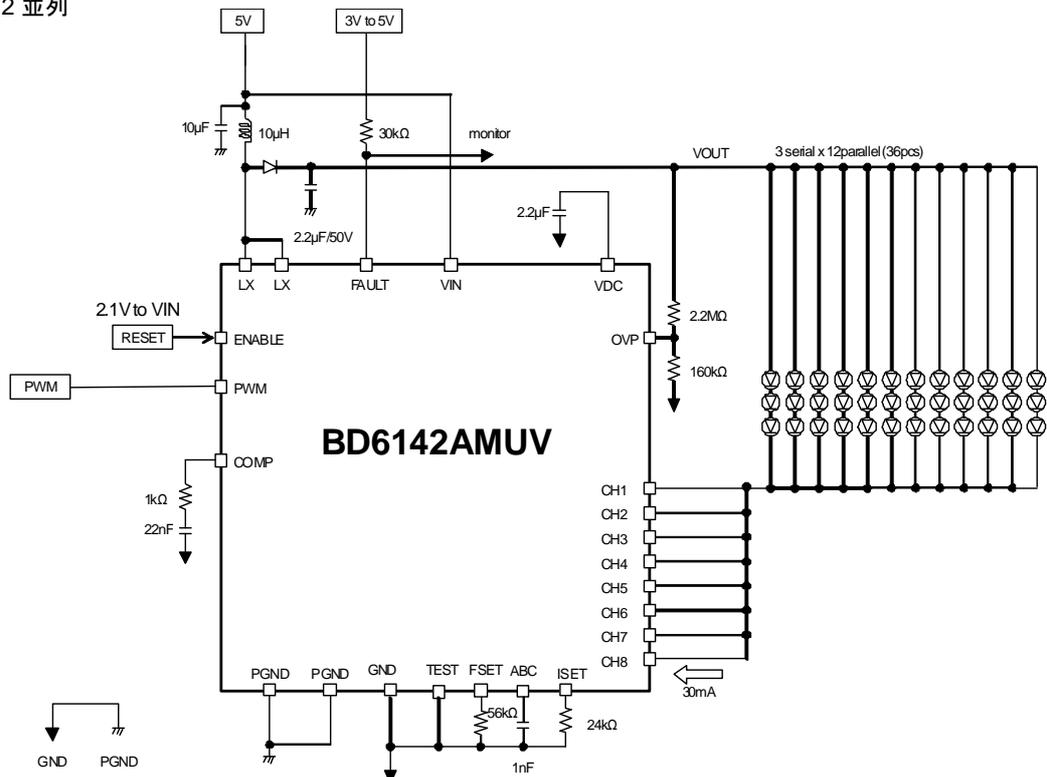


Figure 43. CH 端子ショートアプリケーション例

●使用上の注意

- 1) 絶対最大定格について
印加電圧(VIN)、及び動作温度範囲(Topr)などの絶対最大定格を越えた場合、破壊する恐れがあり、ショートもしくはオープンなどの破壊モードが特定できませんので、絶対最大定格を越えるような特殊モードが想定される場合には、ヒューズなどの物理的な安全対策を施すよう検討をお願いします。
- 2) 推奨動作範囲
この範囲であればほぼ期待通りの特性を得ることができる範囲です。電気特性については各項目の条件下において保証されるものです。
- 3) 電源コネクタの逆接続について
電源コネクタの逆接続により LSI が破壊する恐れがあります。逆接続破壊保護用として外部に電源と LSI の電源端子間にダイオードを入れる等の対策を施してください。
- 4) 電源について
基板パターンの設計においては、電源/GND ラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。また、LSI のすべての電源端子について電源-GND 端子間にコンデンサを挿入するとともに、電解コンデンサ使用の際は、低温で容量ぬげが起こることなど使用するコンデンサの諸特性に問題ないことを十分ご確認のうえ、定数を決定してください。
- 5) GND 電圧について
GND 端子の電位はいかなる動作状態においても、最低電位になるようにしてください。また、実際に過渡現象を含め GND 以下の電位になっている端子がないかご確認ください。
- 6) 端子間ショートと誤装着について
セット基板に取り付ける際、LSI の向きや位置ずれに十分ご注意ください。誤って取り付けた場合、LSI が破壊する恐れがあります。また、端子間や端子と電源、GND 間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊の恐れがあります。
- 7) 強電磁界中の動作について
強電磁界中でのご使用は、誤動作をする可能性がありますのでご注意ください。
- 8) セット基板での検査について
セット基板での検査時に、インピーダンスの低い LSI 端子にコンデンサを接続する場合は、LSI にストレスがかかる恐れがあるので、工程毎に必ず放電を行ってください。また、検査工程での治具への着脱時には、必ず電源をオフしてから接続し、検査を行い、電源をオフしてから取り外してください。さらに、静電気対策として、組み立て工程には、アースを施し、運搬や保存の際には十分ご注意ください。
- 9) 各入力端子について
LSI の構造上、寄生素子は電位関係によって必然的に形成されます。寄生素子が動作することにより、回路動作の干渉を引き起こし、誤動作、ひいては破壊の原因となり得ます。したがって、入力端子に GND より低い電圧を印加するなど、寄生素子が動作するような使い方をしないよう十分注意してください。また、LSI に電源電圧を印加していない時、入力端子に電圧を印加しないでください。さらに、電源電圧を印加している場合にも各入力端子は電源電圧以下の電圧もしくは電気的特性の保証値内としてください。
- 10) アース配線パターンについて
小信号 GND と大電流 GND がある場合、大電流 GND パターンと小信号 GND パターンは分離し、パターン配線の抵抗分と大電流による電圧変化が小信号 GND の電圧を変化させないように、セットの基準点で 1 点アースすることを推奨します。外付け部品の GND の配線パターンも変動しないように注意してください。

- 11) 外付けコンデンサについて
外付けコンデンサに、セラミック・コンデンサを使用する場合、直流バイアスによる公称容量の低下、及び温度などによる容量の変化を考慮の上定数を決定してください。
- 12) サーマルシャットダウン回路(TSD)について
ジャンクション温度が 130°C (typ.)以上になるとサーマルシャットダウン回路が動作しスイッチのOFFを行います。サーマルシャットダウン回路はあくまでも熱的暴走から LSI を遮断することを目的とした回路であり、LSI の保護、及び保証を目的とはしておりません。よって、この回路を動作させての連続使用、及び動作を前提とした使用はしないでください。
- 13) 熱設計について
実際の使用状態での許容損失(Pd)を考えて十分なマージンを持った熱設計を行ってください。
- 14) コイルの選定について
DC/DC コンバータの出力に使用するコイルは損失を少なくするため巻き線抵抗の小さいものを選定してください。

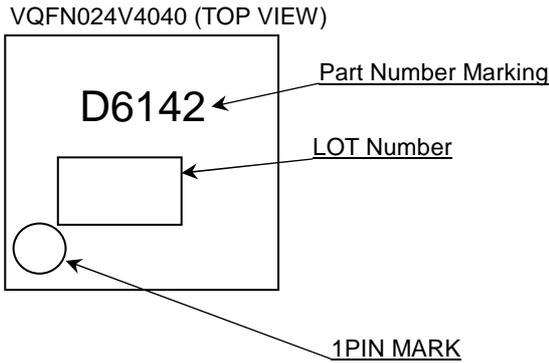
この文書の扱いについて

この文書の日本語版が、正式な仕様書です。この文書の翻訳版は、正式な仕様書を読むための参考としてください。
なお、相違が生じた場合は、正式な仕様書を優先してください。

●発注形名情報

B D 6 1 4 2 A M U V	-	E2
ローム形名	パッケージ MUV: VQFN024V4040	包装、フォーミング仕様 E2: リール状エンボステーピング

●標印図



●外形寸法図と包装・フォーミング仕様

VQFN024V4040

(Unit : mm)

<包装仕様>

包装形態	エンボステーピング
包装数量	2500pcs
包装方向	E2 (リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに) 製品の1番ピンが左上にくる方向

※ご発注の際は、包装数量の倍数をお願い致します。

●改訂記録

Date	Revision	Changes
2012.12.03	001	New Release
2016.11.07	002	P1. パッケージ名、パッケージサイズ 訂正 P4. ESD 等価回路図 訂正

ご注意

ローム製品取扱い上の注意事項

1. 本製品は一般的な電子機器（AV 機器、OA 機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器等）への使用を意図して設計・製造されております。したがって、極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険もしくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器^(Note 1)、輸送機器、交通機器、航空宇宙機器、原子力制御装置、燃料制御、カーアクセサリを含む車載機器、各種安全装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASS III	CLASS III	CLASS II b	Ⅲ類
CLASS IV		CLASS III	

2. 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、かかる誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
 - ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
 - ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。
3. 本製品は、一般的な電子機器に標準的な用途で使用されることを意図して設計・製造されており、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておられません。したがって、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
 - ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
 - ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
 - ③潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
 - ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
 - ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合。
 - ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用。
 - ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合（無洗浄タイプのフラックスを使用された場合も、残渣の洗浄は確実に行うことをお勧め致します）、又ははんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合。
 - ⑧本製品が結露するような場所でのご使用。
4. 本製品は耐放射線設計はなされておられません。
5. 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。
6. パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。
7. 電力損失は周囲温度に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、最高接合部温度を超えていない範囲であることをご確認ください。
8. 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。
9. 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

実装及び基板設計上の注意事項

1. ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。
2. はんだ付けは、表面実装製品の場合リフロー方式、挿入実装製品の場合フロー方式を原則とさせていただきます。なお、表面実装製品をフロー方式での使用をご検討の際は別途ロームまでお問い合わせください。その他、詳細な実装条件及び手はんだによる実装、基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。

応用回路、外付け回路等に関する注意事項

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。
2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。したがって、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

静電気に対する注意事項

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施のうえ、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。(人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等)

保管・運搬上の注意事項

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
 - ①潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所での保管
 - ②推奨温度、湿度以外での保管
 - ③直射日光や結露する場所での保管
 - ④強い静電気が発生している場所での保管
2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を超過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を超過した製品は、はんだ付け性を確認したうえでご使用頂くことを推奨します。
3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き(梱包箱に表示されている天面方向)で取り扱ってください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。
4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を超過した場合はベーク処置を行ったうえでご使用ください。

製品ラベルに関する注意事項

本製品に貼付されている製品ラベルに2次元バーコードが印字されていますが、2次元バーコードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

製品廃棄上の注意事項

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

外国為替及び外国貿易法に関する注意事項

本製品は外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物等に該当するおそれがありますので輸出する場合には、ロームにお問い合わせください。

知的財産権に関する注意事項

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。
2. ロームは、本製品とその他の外部素子、外部回路あるいは外部装置等(ソフトウェア含む)との組み合わせに起因して生じた紛争に関して、何ら義務を負うものではありません。
3. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ロームもしくは第三者が所有又は管理している知的財産権その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。ただし、本製品を通常の用法にて使用される限りにおいて、ロームが所有又は管理する知的財産権を利用されることを妨げません。

その他の注意事項

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。
2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。
3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。
4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社もしくは第三者の商標又は登録商標です。

一般的な注意事項

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。
2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。
3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。